

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日
Date of Application: 2001年12月14日

出 願 番 号
Application Number: 特願2001-382233

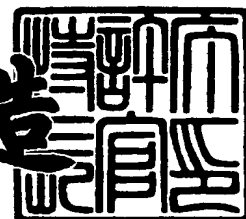
[ST.10/C]: [JP2001-382233]

出 願 人
Applicant(s): 古河電気工業株式会社

2002年 1月25日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2002-3000726

【書類名】 特許願

【整理番号】 A10858

【提出日】 平成13年12月14日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01S 3/18

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 築地 直樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 木村 俊雄

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 愛清 武

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 清水 健男

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

【氏名】 金丸 貞義

【特許出願人】

【識別番号】 000005290

【氏名又は名称】 古河電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100089118

【弁理士】

【氏名又は名称】 酒井 宏明

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-381936

【出願日】 平成12年12月15日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 036711

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0103421

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体レーザ素子、半導体レーザモジュールおよびその製造方法ならびに光ファイバ増幅器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 半導体基板の一部領域上に積層された第 1 の活性層を有し、第 1 のレーザ光を出射する第 1 のストライプと、

前記半導体基板の他の領域上に積層された第 2 の活性層を有し、第 2 のレーザ光を出射する第 2 のストライプと、

を備え、前記第 1 のストライプと前記第 2 のストライプとの中心線間距離は 10 ～ 100 μm であることを特徴とする半導体レーザ素子。

【請求項 2】 前記第 1 のストライプと前記第 2 のストライプとは、互いに平行に延びて形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体レーザ素子。

【請求項 3】 前記第 1 のストライプと前記第 2 のストライプとの内側側面間距離は、5 μm 以上であることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の半導体レーザ素子。

【請求項 4】 前記第 1 の活性層および前記第 2 の活性層の上部に形成された第 1 の電極と、

前記半導体基板の下部に形成された第 2 の電極と、

少なくとも一部がダイヤモンドによって形成されたヒートシンクと、

を備え、前記第 1 の電極あるいは前記第 2 の電極は、前記ヒートシンクの前記ダイヤモンドに接合されることを特徴とする請求項 1 ～ 3 のいずれか一つに記載の半導体レーザ素子。

【請求項 5】 前記第 1 のレーザ光および前記第 2 のレーザ光の波長は、略 1200 nm ～ 略 1600 nm であることを特徴とする請求項 1 ～ 4 のいずれか一つに記載の半導体レーザ素子。

【請求項 6】 請求項 1 ～ 5 のいずれか一つに記載された半導体レーザ素子と、

前記半導体レーザ素子から出射された前記第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光と

が入射され、前記第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光との間隔を広げるように分離させる第 1 レンズと、

前記第 1 レンズを通過した前記第 1 のレーザ光と前記第 2 のレーザ光のいずれか一方のみが入射され、入射されたレーザ光の偏波面を所定の角度回転させる偏光回転手段と、

前記第 1 レンズまたは偏光回転手段からの前記第 1 のレーザ光が入射される第 1 のポートと、前記偏光回転手段または第 1 レンズからの前記第 2 のレーザ光が入射される第 2 のポートと、前記第 1 のポートから入射される第 1 のレーザ光と前記第 2 ポートから入射される第 2 のレーザ光とが合波されて出射される第 3 のポートとを有する偏波合成手段と、

前記偏波合成手段の前記第 3 のポートから出射されるレーザ光を受光し、外部に送出する光ファイバと、

を備えたことを特徴とする半導体レーザモジュール。

【請求項 7】 前記第 1 レンズは、前記第 1 のストライプから出射された第 1 のレーザ光の光軸と前記第 2 のストライプから出射された第 2 のレーザ光の光軸とが、前記第 1 レンズの中心軸を挟んで略対称になるように位置決めされることを特徴とする請求項 6 に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 8】 前記偏波合成手段は、前記第 1 のポートから入射した第 1 のレーザ光と前記第 2 のポートから入射した第 2 のレーザ光のいずれか一方を常光線として前記第 3 のポートに伝搬させるとともに、他方を異常光線として前記第 3 のポートに伝搬させる複屈折素子であることを特徴とする請求項 6 または 7 に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 9】 前記常光線が光ファイバの軸線方向に伝搬するように、前記偏波合成手段の第 1 のポートと第 2 のポートが形成されている各々の面が傾斜して形成されていることを特徴とする請求項 8 に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 10】 前記常光線が光ファイバの軸線方向に伝搬するように、前記半導体レーザ素子および第 1 レンズは、前記軸線方向に対して所定角度傾斜して配置されることを特徴とする請求項 8 に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 11】 前記偏光回転手段および偏波合成手段は、同一のホルダ部

材に固定されていることを特徴とする請求項 6 ～ 1 0 のいずれか一つに記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 1 2】 前記第 1 レンズと前記偏波合成手段との間には、第 1 のレーザ光および第 2 のレーザ光を入射し、互いの光軸を略平行にして出射するプリズムが配設されていることを特徴とする請求項 6 ～ 1 1 のいずれか一つに記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 1 3】 前記プリズム、前記偏光回転手段および偏波合成手段は、同一のホルダ部材に固定されていることを特徴とする請求項 1 2 に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 1 4】 前記偏波合成手段と前記光ファイバとの間に配置され、前記偏波合成手段の第 3 のポートから出射されるレーザ光を前記光ファイバに光結合させる第 2 レンズを有することを特徴とする請求項 6 ～ 1 3 のいずれか一つに記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 1 5】 前記第 1 のレーザ光および第 2 のレーザ光が、前記第 1 レンズと前記第 2 レンズとの間で焦点を結ぶように前記第 1 レンズが位置決めされていることを特徴とする請求項 1 4 に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 1 6】 所定の波長の光を半導体レーザ素子に帰還させる光反射部が設けられていることを特徴とする請求項 6 ～ 1 5 のいずれか一つに記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 1 7】 前記光反射部は、前記光ファイバに形成されたファイバグレーティングであることを特徴とする請求項 1 6 に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 1 8】 前記半導体レーザ素子を冷却する冷却装置と、前記冷却装置上に固定され、前記半導体レーザ素子を載置する基台とを有し、前記第 1 レンズ、前記偏光回転手段および偏波合成手段は、前記基台上に固定されていることを特徴とする請求項 6 ～ 1 7 のいずれか一つに記載の半導体レーザモジュール。

【請求項 1 9】 前記基台は、前記半導体レーザ素子を固定する第 1 の基台と、前記第 1 の基台上に固定され、前記第 1 レンズ、前記偏光回転手段および偏光合成手段を固定する第 2 の基台とからなることを特徴とする請求項 1 8 に記載

の半導体レーザモジュール。

【請求項 2 0】 請求項 6 に記載された半導体レーザモジュールの製造方法において、

前記半導体レーザ素子を基台上に固定する第 1 の工程と、

前記半導体レーザ素子からレーザ光を出射した状態で、前記第 1 レンズを調芯して前記基台上に固定する第 2 の工程と、

前記半導体レーザ素子からレーザ光を出射した状態で、前記偏光回転手段を調芯して前記基台上に固定する第 3 の工程と、

前記半導体レーザ素子からレーザ光を出射した状態で、前記偏波合成手段を調芯して前記基台上に固定する第 4 の工程と、

前記半導体レーザ素子からレーザ光を出射した状態で、前記光ファイバを調芯して固定する第 5 の工程と、

を含むことを特徴とする半導体レーザモジュールの製造方法。

【請求項 2 1】 前記偏光回転手段および偏波合成手段は、同一のホルダ部材に固定されており、前記ホルダ部材を調芯することによって、前記第 3 の工程と前記第 4 の工程とを同時に行うことを特徴とする請求項 2 0 に記載の半導体レーザモジュールの製造方法。

【請求項 2 2】 前記第 1 レンズと前記偏波合成手段との間には、第 1 のレーザ光および第 2 のレーザ光を入射し、互いの光軸を略平行にして出射するプリズムが配設され、前記プリズム、前記偏光回転手段および偏波合成手段は、同一のホルダ部材に固定されており、前記ホルダ部材を調芯することによって、前記第 3 の工程と前記第 4 の工程とを同時に行うことを特徴とする請求項 2 0 に記載の半導体レーザモジュールの製造方法。

【請求項 2 3】 前記ホルダ部材の調芯は、

前記半導体レーザ素子の第 1 のストライプおよび第 2 のストライプの双方からレーザ光を出射させる工程と、

前記第 1 のストライプから出射される第 1 のレーザ光を前記偏波合成手段の第 1 のポートに入射させるとともに前記第 2 のストライプから出射される第 2 のレーザ光を前記偏波合成手段の第 2 のポートに入射させる工程と、

前記ホルダ部材を中心軸の周りに回転させて前記第 1 のポートに入射した前記第 1 のレーザ光と第 2 のポートに入射した第 2 のレーザ光とがともに第 3 のポートから出射されるように位置調整する工程と、

前記位置調整する工程後に前記ホルダ部材の前記中心軸周りの位置を固定する工程と、

を含むことを特徴とする請求項 2 1 または 2 2 に記載の半導体レーザモジュールの製造方法。

【請求項 2 4】 請求項 6 ～ 1 9 のいずれか一つに記載の半導体レーザモジュールと、信号光が伝送される光ファイバとを有し、前記半導体レーザモジュールから出射される励起光と前記光ファイバに伝送される信号光とを合波して前記信号光に利得を与えることを特徴とする光ファイバ増幅器。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

この発明は、半導体レーザ素子、半導体レーザモジュールおよびその製造方法ならびにその半導体レーザモジュールを用いた光ファイバ増幅器に関し、特に、2 つのレーザ光を出射させる 2 つのストライプ構造を備えた半導体レーザ素子、半導体レーザモジュールおよびその製造方法ならびに光ファイバ増幅器に関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年における高密度波長分割多重伝送方式による光通信の進展に伴い、光ファイバ増幅器に使用される励起光源に対する高出力化の要求が益々高まっている。

【0 0 0 3】

また、最近では、光ファイバ増幅器として従来から使用されてきたエルビウムドープ光ファイバ増幅器よりも、更に広帯域の光を増幅する手段としてラマン増幅器に対する期待が高まっている。ラマン増幅は、光ファイバに励起光を入射したときに発生する誘導ラマン散乱によって、励起光波長から約 1 3 T H z 低周波側に利得が現れ、このように励起された状態の光ファイバに、上記利得を有する

波長帯域の信号光を入力すると、その信号光が増幅されるという現象を利用した光信号の増幅方法である。

【 0 0 0 4 】

ラマン増幅においては、信号光と励起光（ポンプ光）の偏波方向が一致している状態で信号光が増幅されるので、信号光と励起光との偏波面のずれの影響を極力小さくする必要がある。そのため、励起光の偏波を解消（非偏光化：デポラライズ）して、偏光度（DOP:Degree Of Polarization）を低減させることが行われている。

【 0 0 0 5 】

このように、励起光源の高出力化および無偏光化を同時に実現する方法として、たとえば米国特許第 5 5 8 9 6 8 4 号公報に開示されているように、同一波長で発振する 2 つの半導体レーザモジュールから出力されたレーザ光を偏波合成カブラによって偏波合成する方法が知られている。

【 0 0 0 6 】

図 2 1 は、米国特許第 5 5 8 9 6 8 4 号公報に開示された半導体レーザ装置を説明するための説明図である。図 2 1 に示すように、従来の半導体レーザ装置は、同一波長で互いに直交する方向にレーザ光を出射する第 1 の半導体レーザ素子 6 0 および第 2 の半導体レーザ素子 6 1 と、第 1 の半導体レーザ素子 6 0 から出射されたレーザ光を平行にする第 1 の平行レンズ 6 2 と、第 2 の半導体レーザ素子 6 1 から出射されたレーザ光を平行にする第 1 の平行レンズ 6 3 と、第 1 の平行レンズ 6 2 および第 2 の平行レンズ 6 3 によって平行になったレーザ光を直交偏波合成する偏波合成カブラ 6 4 と、偏波合成カブラ 6 4 によって偏波合成されたレーザ光を集光する集光レンズ 6 5 と、集光レンズ 6 5 によって集光されたレーザ光が入射され外部に送出するファイバグレーティング 6 6 付き光ファイバ 6 7 とを有する。

【 0 0 0 7 】

従来の半導体レーザ装置によれば、第 1 の半導体レーザ素子 6 0 および第 2 の半導体レーザ素子 6 1 から互いに直交する方向に出射されたレーザ光が偏波合成カブラ 6 4 によって偏波合成されるので、光ファイバ 6 7 からは偏光度の小さい

レーザ光を出力することができる。また、光ファイバ67にファイバグレーティング66が形成されているので、半導体レーザ素子60、61の発振波長が同一波長に固定され、光ファイバ67から波長が固定されたレーザ光を出力することができる。

【0008】

従って、上記の従来の半導体レーザ装置は、高い光出力が要求される光ファイバ増幅器の励起光源、とりわけ低偏波依存性および波長安定性が要求されるラマン増幅器の励起光源として適用することが可能である。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、従来の半導体レーザ装置では、2個の半導体レーザ素子60、61をそれぞれ取り付けた2個のチップキャリアを基台上に半田付けして配置する必要がある。このとき、2個の半導体レーザ素子60、61から出射されるレーザ光が互いに直交するように位置決めする必要があるため、半導体レーザ素子の位置決め時間が長くなる。その結果、半導体レーザモジュールの製造時間が長くなる。

【0010】

また、各半導体レーザ素子60、61からの出射光が互いに全く異方向に出力されるため、高温状態において、各方向において生じるパッケージの反り等の影響によって、光ファイバから出力される光の光強度および偏光度を安定化させることが困難である。

【0011】

この発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであり、2つのレーザ光を出射させる2つのストライプを備えた半導体レーザ素子を用い、半導体レーザ素子の位置決め時間およびレンズの調芯時間を短くするとともに、半導体レーザモジュールから出力されるレーザ光の光強度および偏光度の安定化を図ることができる半導体レーザ素子、半導体レーザモジュールおよびその製造方法ならびに光ファイバ増幅器を提供することを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、請求項 1 にかかる半導体レーザ素子は、半導体基板の一部領域上に積層された第 1 の活性層を有し、第 1 のレーザ光を出射する第 1 のストライプと、前記半導体基板の他の領域上に積層された第 2 の活性層を有し、第 2 のレーザ光を出射する第 2 のストライプとを備え、前記第 1 のストライプと前記第 2 のストライプとの中心線間距離は $10 \sim 100 \mu\text{m}$ であることを特徴とする。

【0013】

また、請求項 2 にかかる半導体レーザ素子は、上記の発明において、前記第 1 のストライプと前記第 2 のストライプとは、互いに平行に延びて形成されていることを特徴とする。

【0014】

また、請求項 3 にかかる半導体レーザ素子は、上記の発明において、前記第 1 のストライプと前記第 2 のストライプとの内側側面間距離は、 $5 \mu\text{m}$ 以上であることを特徴とする。

【0015】

また、請求項 4 にかかる半導体レーザ素子は、上記の発明において、前記第 1 の活性層および前記第 2 の活性層の上部に形成された第 1 の電極と、前記半導体基板の下部に形成された第 2 の電極と、少なくとも一部が CVD ダイアモンドによって形成されたヒートシンクとを備え、前記第 1 の電極あるいは前記第 2 の電極は、前記ヒートシンクの前記 CVD ダイアモンドに接合されることを特徴とする。

【0016】

また、請求項 5 にかかる半導体レーザ素子は、上記の発明において、前記第 1 のレーザ光および前記第 2 のレーザ光の波長は、略 $1200 \text{ nm} \sim$ 略 1600 nm であることを特徴とする。

【0017】

また、請求項 6 にかかる半導体レーザモジュールは、請求項 1 ～ 5 のいずれか一つに記載された半導体レーザ素子と、前記半導体レーザ素子から出射された前

前記第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光とが入射され、前記第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光との間隔を広げるように分離させる第 1 レンズと、前記第 1 レンズを通過した前記第 1 のレーザ光と前記第 2 のレーザ光のいずれか一方のみが入射され、入射されたレーザ光の偏波面を所定の角度回転させる偏光回転手段と、前記第 1 レンズまたは偏光回転手段からの前記第 1 のレーザ光が入射される第 1 のポートと、前記偏光回転手段または第 1 レンズからの前記第 2 のレーザ光が入射される第 2 のポートと、前記第 1 のポートから入射される第 1 のレーザ光と前記第 2 ポートから入射される第 2 のレーザ光とが合波されて出射される第 3 のポートとを有する偏波合成手段と、前記偏波合成手段の前記第 3 のポートから出射されるレーザ光を受光し、外部に送出する光ファイバとを備えたことを特徴とする。

【 0 0 1 8 】

また、請求項 7 にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記第 1 レンズは、前記第 1 のストライプから出射された第 1 のレーザ光の光軸と前記第 2 のストライプから出射された第 2 のレーザ光の光軸とが、前記第 1 レンズの中心軸を挟んで略対称になるように位置決めされることを特徴とする。

【 0 0 1 9 】

また、請求項 8 にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記偏波合成手段は、前記第 1 のポートから入射した第 1 のレーザ光と前記第 2 のポートから入射した第 2 のレーザ光のいずれか一方を常光線として前記第 3 のポートに伝搬させるとともに、他方を異常光線として前記第 3 のポートに伝搬させる複屈折素子であることを特徴とする。

【 0 0 2 0 】

また、請求項 9 にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記常光線が光ファイバの軸線方向に伝搬するように、前記偏波合成手段の第 1 のポートと第 2 のポートが形成されている各々の面が傾斜して形成されていることを特徴とする。

【 0 0 2 1 】

また、請求項 1 0 にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記常光線が光ファイバの軸線方向に伝搬するように、前記半導体レーザ素子お

よび第 1 レンズは、前記軸線方向に対して所定角度傾斜して配置されることを特徴とする。

【 0 0 2 2 】

また、請求項 1 1 にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記偏光回転手段および偏波合成手段は、同一のホルダ部材に固定されていることを特徴とする。

【 0 0 2 3 】

また、請求項 1 2 にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記第 1 レンズと前記偏波合成手段との間には、第 1 のレーザ光および第 2 のレーザ光を入射し、互いの光軸を略平行にして出射するプリズムが配設されていることを特徴とする。

【 0 0 2 4 】

また、請求項 1 3 にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記プリズム、前記偏光回転手段および偏波合成手段は、同一のホルダ部材に固定されていることを特徴とする。

【 0 0 2 5 】

また、請求項 1 4 にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記偏波合成手段と前記光ファイバとの間に配置され、前記偏波合成手段の第 3 のポートから出射されるレーザ光を前記光ファイバに光結合させる第 2 レンズを有することを特徴とする。

【 0 0 2 6 】

また、請求項 1 5 にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記第 1 のレーザ光および第 2 のレーザ光が、前記第 1 レンズと前記第 2 レンズとの間で焦点を結ぶように前記第 1 レンズが位置決めされていることを特徴とする。

【 0 0 2 7 】

また、請求項 1 6 にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、所定の波長の光を半導体レーザ素子に帰還させる光反射部が設けられていることを特徴とする。

【 0 0 2 8 】

また、請求項 1 7 にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記光反射部は、前記光ファイバに形成されたファイバグレーティングであることを特徴とする。

【 0 0 2 9 】

また、請求項 1 8 にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記半導体レーザ素子を冷却する冷却装置と、前記冷却装置上に固定され、前記半導体レーザ素子を載置する基台とを有し、前記第 1 レンズ、前記偏光回転手段および偏波合成手段は、前記基台上に固定されていることを特徴とする。

【 0 0 3 0 】

また、請求項 1 9 にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記基台は、前記半導体レーザ素子を固定する第 1 の基台と、前記第 1 の基台上に固定され、前記第 1 レンズ、前記偏光回転手段および偏光合成手段を固定する第 2 の基台とからなることを特徴とする。

【 0 0 3 1 】

また、請求項 2 0 にかかる半導体レーザモジュールの製造方法は、請求項 6 に記載された半導体レーザモジュールの製造方法において、前記半導体レーザ素子を基台上に固定する第 1 の工程と、前記半導体レーザ素子からレーザ光を出射した状態で、前記第 1 レンズを調芯して前記基台上に固定する第 2 の工程と、前記半導体レーザ素子からレーザ光を出射した状態で、前記偏光回転手段を調芯して前記基台上に固定する第 3 の工程と、前記半導体レーザ素子からレーザ光を出射した状態で、前記偏波合成手段を調芯して前記基台上に固定する第 4 の工程と、前記半導体レーザ素子からレーザ光を出射した状態で、前記光ファイバを調芯して固定する第 5 の工程とを含むことを特徴とする。

【 0 0 3 2 】

また、請求項 2 1 にかかる半導体レーザモジュールの製造方法は、上記の発明において、前記偏光回転手段および偏波合成手段は、同一のホルダ部材に固定されており、前記ホルダ部材を調芯することによって、前記第 3 の工程と前記第 4 の工程とを同時に行うことを特徴とする。

【 0 0 3 3 】

また、請求項 2 2 にかかる半導体レーザモジュールの製造方法は、上記の発明において、前記第 1 レンズと前記偏波合成手段との間には、第 1 のレーザ光および第 2 のレーザ光を入射し、互いの光軸を略平行にして出射するプリズムが配設され、前記プリズム、前記偏光回転手段および偏波合成手段は、同一のホルダ部材に固定されており、前記ホルダ部材を調芯することによって、前記第 3 の工程と前記第 4 の工程とを同時に行うことを特徴とする。

【 0 0 3 4 】

また、請求項 2 3 にかかる半導体レーザモジュールの製造方法は、上記の発明において、前記ホルダ部材の調芯は、前記半導体レーザ素子の第 1 のストライプおよび第 2 のストライプの双方からレーザ光を出射させる工程と、前記第 1 のストライプから出射される第 1 のレーザ光を前記偏波合成手段の第 1 のポートに入射させるとともに前記第 2 のストライプから出射される第 2 のレーザ光を前記偏波合成手段の第 2 のポートに入射させる工程と、前記ホルダ部材を中心軸の周りに回転させて前記第 1 のポートに入射した前記第 1 のレーザ光と第 2 のポートに入射した第 2 のレーザ光とがともに第 3 のポートから出射されるように位置調整する工程と、前記位置調整する工程後に前記ホルダ部材の前記中心軸周りの位置を固定する工程とを含むことを特徴とする。

【 0 0 3 5 】

また、請求項 2 4 にかかる光ファイバ増幅器は、請求項 6 ～ 1 9 のいずれか一つに記載の半導体レーザモジュールと、信号光が伝送される光ファイバとを有し、前記半導体レーザモジュールから出射される励起光と前記光ファイバに伝送される信号光とを合波して前記信号光に利得を与えることを特徴とする。

【 0 0 3 6 】

【発明の実施の形態】

以下に図面を参照して、この発明にかかる半導体レーザ素子、半導体レーザモジュールおよびその製造方法ならびに光ファイバ増幅器の好適な実施の形態について説明する。

【 0 0 3 7 】

(実施の形態 1)

まず、この発明の実施の形態 1 について説明する。図 1 は、実施の形態 5 にかかる半導体レーザモジュールの構成を示す断面図であり、図 2 はこの発明の実施の形態 1 にかかる半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【0038】

図 1 に示すように、この実施の形態 1 にかかる半導体レーザモジュール M 1 は、内部を気密封止したパッケージ 1 と、そのパッケージ 1 内に設けられ、レーザ光を出射する半導体レーザ素子 2 と、フォトダイオード 3 と、第 1 レンズ 4 と、プリズム 5 と、半波長板（偏光回転手段） 6 と、偏波合成部材（P B C : Polarization Beam Combiner） 7 と、光ファイバ 8 とを有する。

【0039】

半導体レーザ素子 2 は、図 2 に示すように、間隔を隔てて長手方向に互いに同一平面上に平行に形成された第 1 のストライプ 9 及び第 2 のストライプ 1 0 を有し、第 1 のストライプ 9 及び第 2 のストライプ 1 0 の端面からそれぞれ第 1 のレーザ光 K 1 及び第 2 のレーザ光 K 2 を出射する。図 2 中に示す K 1, K 2 は、それぞれ第 1 のストライプ 9 及び第 2 のストライプ 1 0 から出射されるビームの中心の軌跡を示す。ビームは、図 2 に破線で示すように、この中心のまわりに、ある広がりをもって伝搬する。第 1 のストライプ 9 と第 2 のストライプ 1 0 との間隔は、例えば約 4 0 μ m 程度である。

【0040】

半導体レーザ素子 2 はチップキャリア 1 1 上に固定して取り付けられる。なお、半導体レーザ素子 2 は、ヒートシンク（図示せず）上に固定して取り付けられ、そのヒートシンクがチップキャリア 1 1 上に固定して取り付けられていてもよい。

【0041】

フォトダイオード 3 は、半導体レーザ素子 2 の後側（図 1 では左側）端面 2 b から出射されたモニタ用のレーザ光を受光する。フォトダイオード 3 は、フォトダイオードキャリア 1 2 に固定して取り付けられている。

【 0 0 4 2 】

第 1 レンズ 4 は、半導体レーザ素子 2 の前側（図 1 では右側）端面 2 a から出射された第 1 のレーザ光 K 1 と第 2 のレーザ光 K 2 とが入射され、第 1 のレーザ光 K 1 と第 2 のレーザ光 K 2 との間隔を広げるように、それぞれの光を異なる焦点位置（F 1、F 2）に集光させる作用をもつ。

【 0 0 4 3 】

第 1 レンズ 4 は、第 1 のレンズ保持部材 1 3 によって保持されている。第 1 レンズ 4 は、第 1 のストライプ 9 から出射された第 1 のレーザ光 K 1 の光軸と第 2 のストライプ 1 0 から出射された第 2 のレーザ光 K 2 の光軸とが、第 1 レンズ 4 の中心軸を挟んで略対称になるように位置決めされるのが好ましい。これによって、第 1 のレーザ光 K 1 及び第 2 のレーザ光 K 2 が、ともに収差の小さい領域である第 1 レンズ 4 の中心軸近傍を通過するため、レーザ光の波面の乱れがなくなり、光ファイバ 8 との光結合効率が高くなる。その結果、より高出力の半導体レーザモジュール M 1 が得られる。なお、球面収差の影響を抑えるためには、第 1 レンズ 4 は、球面収差が小さく光ファイバ 8 との結合効率が高くなる非球面レンズを用いるのが好ましい。

【 0 0 4 4 】

プリズム 5 は、第 1 レンズ 4 と偏波合成部材 7 との間に配設され、入射された第 1 のレーザ光 K 1 及び第 2 のレーザ光 K 2 を、互いの光軸を略平行にして出射する。プリズム 5 は、B X 7（ホウケイ酸クラウンガラス）等の光学ガラスで作られている。第 1 レンズ 4 から非平行に伝搬する第 1 及び第 2 のレーザ光 K 1、K 2 の光軸が、プリズム 5 の屈折により、平行とされるため、このプリズム 5 の後方に配置される偏波合成部材 7 の作製が容易になるとともに、偏波合成部材 7 を小型化し半導体レーザモジュール M 1 を小型にすることが可能となる。

【 0 0 4 5 】

図 3（A）はプリズム 5 の構成を示す側面図であり、図 3（B）はその平面図である。図 3 に示すように、プリズム 5 は、平坦状に形成された入射面 5 a と、所定角度 θ に傾斜した出射面 5 b とを有する。たとえば、プリズム 5 が B K 7 で作製され、半導体レーザ素子 2 の各ストライプ 9、1 0 間の間隔が $40\ \mu\text{m}$ で、

焦点距離 0.7 mm の第 1 レンズ 4 を使用する場合には、プリズム 5 の全長 L_1 は約 1.0 mm となり、所定角度 θ は $3.2 \pm 0.1^\circ$ となる。

【0046】

半波長板 6 は、プリズム 5 を通過した第 1 のレーザ光 K_1 と第 2 のレーザ光 K_2 のうち、第 1 のレーザ光 K_1 のみが入射され、入射された第 1 のレーザ光 K_1 の偏波面を 90 度回転させる。

【0047】

偏波合成部材 7 は、第 1 のレーザ光 K_1 が入射される第 1 のポート 7 a と、第 2 のレーザ光 K_2 が入射される第 2 のポート 7 b と、第 1 のポート 7 a から入射される第 1 のレーザ光 K_1 と第 2 のポート 7 b から入射される第 2 のレーザ光 K_2 とが合波されて出射される第 3 のポート 7 c とを有する。偏波合成部材 7 は、例えば、第 1 のレーザ光 K_1 を常光線として第 3 のポート 7 c に伝搬させるとともに、第 2 のレーザ光 K_2 を異常光線として第 3 のポート 7 c に伝搬させる複屈折素子である。偏波合成部材 7 が複屈折素子の場合、複屈折率性が高くレーザ光間の分離幅を大きくとれるように、例えば TiO_2 (ルチル) で作られる。

【0048】

この実施の形態 1 においてはプリズム 5、半波長板 6 及び偏波合成部材 7 は、同一のホルダ部材 14 に固定されている。図 4 (A) はプリズム 5、半波長板 6 及び偏波合成部材 7 を固定するホルダ部材 14 を示す平面図であり、図 4 (B) はその側面断面図であり、図 4 (C) はその正面図である。図 4 に示すように、ホルダ部材 14 は、YAG レーザ溶接が可能な材料 (例えば SUS 403, 304 等) で作られ、その全長 L_2 は約 7.0 mm であり、全体が略円柱状に形成されている。ホルダ部材 14 の内部に収容部 14 a が形成され、その収容部 14 a にプリズム 5、半波長板 6 及び偏波合成部材 7 がそれぞれ固定される。ホルダ部材 14 の上部は開口され、その下部は平坦状に形成されている。

【0049】

これによって、偏波合成部材 7 の第 1 のポート 7 a から入射する第 1 のレーザ光 K_1 及び第 2 のポート 7 b から入射する第 2 のレーザ光 K_2 をともに第 3 のポート 7 c から出射するように、プリズム 5、偏波合成部材 7 の中心軸 C_1 周りの

位置を調整することが非常に容易になる。

【 0 0 5 0 】

光ファイバ 8 は、偏波合成部材 7 の第 3 のポート 7 c から出射されるレーザ光を受光し外部に送出する。光ファイバ 8 には、図 2 に示すように、所定の波長帯の光を反射するファイバグレーティングからなる光反射部 1 5 が設けられている。この光反射部 1 5 によって、所定波長の光が半導体レーザ素子 2 に帰還され、半導体レーザ素子 2 の発振波長が固定されるとともに、発振スペクトル幅を狭くすることができる。従って、この半導体レーザモジュール M 1 からの出力光を、波長合成カプラ (WDM) により合波して、エルビウムドープ光ファイバ増幅器やラマン増幅器の励起光源として用いた場合には、波長合成カプラの損失を低く抑えて高出力の合波光を得ることができるとともに、ラマン増幅器に使用した場合には、ラマン増幅の利得変動を抑えることができる。光反射部 1 5 は、例えばフェーズマスクを介して干渉縞となった紫外光を光ファイバ 8 のコア部に照射することによって周期的に屈折率の変化を生じさせて形成される。

【 0 0 5 1 】

偏波合成部材 7 と光ファイバ 8 との間には、偏波合成部材 7 の第 3 のポート 7 c から出射されるレーザ光を光ファイバ 8 に光結合させる第 2 レンズ 1 6 が配設されている。第 1 のレーザ光 K 1 及び第 2 のレーザ光 K 2 は、第 1 レンズ 4 と第 2 レンズ 1 6 との間で焦点 (F 1, F 2) を結ぶように第 1 レンズ 4 が位置合わせされている。これによって、第 1 レンズ 4 と焦点 (F 1, F 2) 間におけるレーザ光のスポットサイズが小さくなって、両レーザ光の重なりが防止されるので、第 1 のレーザ光 K 1 の光路上にのみ、半波長板 6 を挿入できるために十分な第 1 のレーザ光 K 1 と第 2 のレーザ光 K 2 との分離幅 D' を得るために必要な伝搬距離 L が短くなる。このため、半導体レーザモジュール M 1 の光軸方向の長さを短くすることができる。その結果、例えば高温環境下における半導体レーザ素子 2 と光ファイバ 8 との光結合の経時安定性が優れた、信頼性の高い半導体レーザモジュール M 1 を提供できる。

【 0 0 5 2 】

半導体レーザ素子 2 を固定したチップキャリア 1 1 と、フォトダイオード 3 を

固定したフォトダイオードキャリア 1 2 とは、断面略 L 字形状の第 1 の基台 1 7 上に半田付けして固定される。第 1 の基台 1 7 は、半導体レーザ素子 2 の発熱に対する放熱性を高めるために Cu W 系合金等で作られているのが好ましい。

【 0 0 5 3 】

第 1 レンズ 4 を固定した第 1 のレンズ保持部材 1 3 と、プリズム 5、半波長板 6 及び偏波合成部材 7 を固定したホルダ部材 1 4 とは、第 2 の基台 1 8 上にそれぞれ第 1 の支持部材 1 9 a 及び第 2 の支持部材 1 9 b を介して Y A G レーザ溶接により、固定される。このため、第 2 の基台 1 8 は、溶接性の良好なステンレス鋼等で作られているのが好ましい。また、第 2 の基台 1 8 は、第 1 の基台 1 7 の平坦部 1 7 a 上に銀ろう付けして固定される。

【 0 0 5 4 】

第 1 の基台 1 7 の下部にはペルチェ素子からなる冷却装置 2 0 が設けられている。半導体レーザ素子 2 からの発熱による温度上昇はチップキャリア 1 1 上に設けられたサーミスタ 2 0 a によって検出され、サーミスタ 2 0 a より、検出された温度が一定温度になるように、冷却装置 2 0 が制御される。これによって、半導体レーザ素子 2 のレーザ出力を高出力化かつ安定化させることができる。

【 0 0 5 5 】

パッケージ 1 の側部に形成されたフランジ部 1 a の内部には、偏波合成部材 7 を通過した光が入射する窓部 1 b が設けられ、フランジ部 1 a の端面には中間部材 1 d が固定されている。中間部材 1 d 内にはレーザ光を集光する第 2 レンズ 1 6 を保持する第 2 のレンズ保持部材 2 1 が Y A G レーザ溶接により固定されている。第 2 のレンズ保持部材 2 1 の端部には金属製のスライドリング 2 2 が Y A G レーザ溶接により固定される。

【 0 0 5 6 】

光ファイバ 8 はフェルール 2 3 によって保持され、そのフェルール 2 3 は、スライドリング 2 2 の内部に Y A G レーザ溶接により固定されている。

【 0 0 5 7 】

次に、実施の形態 1 にかかる半導体レーザモジュール M 1 の動作について説明する。半導体レーザ素子 2 の第 1 のストライプ 9 及び第 2 のストライプ 1 0 の前

側端面 2 a からそれぞれ出射された第 1 のレーザ光 K 1 及び第 2 のレーザ光 K 2 は、第 1 レンズ 4 を通過し、交差した後、間隔が広がりプリズム 5 に入射される。プリズム 5 に入射した時の第 1 のレーザ光 K 1 と第 2 のレーザ光 K 2 との間隔 (D) は約 $460\text{ }\mu\text{m}$ である。プリズム 5 によって第 1 のレーザ光 K 1 と第 2 のレーザ光 K 2 は略平行となって出射し (両者の間隔は約 $500\text{ }\mu\text{m}$ になる)、第 1 のレーザ光 K 1 は半波長板 6 に入射され、偏波面を 90 度回転させた後、偏波合成部材 7 の第 1 のポート 7 a に入射され、第 2 のレーザ光 K 2 は偏波合成部材 7 の第 2 のポート 7 b に入射される。

【 0 0 5 8 】

偏波合成部材 7 では、第 1 のポート 7 a から入射される第 1 のレーザ光 K 1 と第 2 のポート 7 b から入射される第 2 のレーザ光 K 2 とが合波されて第 3 のポート 7 c から出射される。

【 0 0 5 9 】

偏波合成部材 7 から出射されたレーザ光は、第 2 レンズ 1 6 によって集光され、フェルルール 2 3 によって保持された光ファイバ 8 の端面に入射され外部に送出される。また、光ファイバ 8 の光反射部 1 5 によってレーザ光の一部が反射され、反射された光は、半導体レーザ素子 2 に帰還され、半導体レーザ素子 2 と光反射部 1 5 との間で外部共振器が構成されるので、光反射部 1 5 によって決定される波長帯でのレーザ発振が可能となる。

【 0 0 6 0 】

一方、半導体レーザ素子 2 の後側端面 2 b から出射されたモニタ用のレーザ光は、フォトダイオード 3 によって受光され、フォトダイオード 3 の受光量等を算出することにより半導体レーザ素子 2 の光出力等を調整する。

【 0 0 6 1 】

この実施の形態 1 にかかる半導体レーザモジュール M 1 によれば、半導体レーザ素子 2 から第 1 のレーザ光 K 1 及び第 2 のレーザ光 K 2 が出射され、半波長板 6 によって第 1 のレーザ光 K 1 の偏光面が 90 度回転し、偏波合波部材 7 によって第 1 のレーザ光 K 1 と第 2 のレーザ光 K 2 が偏波合成されるので、光ファイバ 8 からは高出力で、かつ偏光度の小さいレーザ光を出力することができる。また

、光ファイバ 8 にファイバグレーティングからなる光反射部 1 5 が形成されているので、光ファイバ 8 から波長が固定されたレーザ光を出力することができる。従って、上記の半導体レーザモジュール M 1 を、高出力が要求されるエルビウムドープ光ファイバ増幅器や、さらに低偏波依存性及び波長安定性が要求されるラマン増幅器の励起光源として適用することができる。

【 0 0 6 2 】

また、2 つのレーザ光を出射させる 2 つのストライプを備えた 1 個の半導体レーザ素子 2 だけを用いているので、半導体レーザ素子 2 の位置決め時間が短くなる。その結果、半導体レーザモジュール M 1 の製造時間を短縮化できる。

【 0 0 6 3 】

また、従来は 2 つの半導体レーザ素子からそれぞれ全く異なる軸方向に光が出射されるため、そのそれぞれの軸方向でのパッケージの反り等を考慮して半導体レーザモジュールを設計しなければ、環境温度の変化等によって生じたパッケージの反りによる光出力変動を抑制できなかったが、この実施の形態 1 の構成によれば、1 個の半導体レーザ素子から出力される 2 つの光はほぼ同じ方向に伝搬されるため、パッケージの反りの影響を 1 方向においてのみ抑制することにより、光ファイバ 8 から出力される光の強度の安定化を図ることができる。

【 0 0 6 4 】

また、1 個の半導体レーザ素子から 2 つの光を出力することにより、これら 2 つの光はパッケージの反り等に対して、光ファイバ 8 との結合効率が同じ傾向で変動する。従って、温度変動等があった場合でも光ファイバ 8 から出力される光の偏光度が安定化する。

【 0 0 6 5 】

次に、この発明の実施の形態 1 にかかる半導体レーザモジュール M 1 の製造方法について説明する。まず、第 1 の基台 1 7 の平坦部 1 7 a 上に第 2 の基台 1 8 を銀ろう付けして固定する。

【 0 0 6 6 】

その後、半導体レーザ素子 2 を固定したチップキャリア 1 1 と、フォトダイオード 3 を固定したフォトダイオードキャリア 1 2 を第 1 の基台 1 7 上に半田付け

して固定する。

【0067】

その後、第2の基台18上に第1レンズ4を調芯して固定する。この第1レンズ4の調芯工程では、半導体レーザ素子2に電流を供給して第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2を半導体レーザ素子2の第1のストライプ9及び第2のストライプ10の双方から出射させ、その出射方向を基準方向として設定した後、第1レンズ4を挿入し、XYZ軸方向の位置を決める。

【0068】

図5は、第1レンズの調芯工程を説明するための説明図である。X軸方向については、図5(A)に示すように、上記のようにして設定された基準方向(中心軸C2)と第1のレーザ光K1との角度 θ_1 と、中心軸C2と第2のレーザ光K2との角度 θ_2 とが等しくなる位置で決める。Y軸方向については、図5(B)に示すように、第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2が第1レンズ4の中心を通る位置で決める。Z軸については、半導体レーザ素子2からの規定の距離で、レーザ光のスポット径が最小となる位置で決める。以上の調芯工程で決まった位置で第1レンズ4を保持する第1のレンズ保持部材13を、第2の基台18上に第1の支持部材19aを介してYAGレーザ溶接して固定する。

【0069】

その後、第2の基台18上に、プリズム5、半波長板6、偏波合成部材7を一体化したホルダ部材14を調芯して固定する。このホルダ部材14の調芯工程では、位置合わせ用光ファイバコリメータを用いて、そのファイバに結合する光強度が最大になるように、ホルダ部材14の中心軸C1(図4参照)回り θ 、XYZ軸方向の位置を決める。ホルダ部材14の中心軸C1回りの位置決めでは、ホルダ部材14を中心軸C1の周りに回転させて第1のポート7aに入射した第1のレーザ光K1と第2のポート7bに入射した第2のレーザ光K2がともに第3のポート7cから出射されるように位置調整する。以上の調芯工程で決まった位置でホルダ部材14を第2の基台18上に第2の支持部材19bを介してYAGレーザ溶接して固定する。

【0070】

その後、第 1 の基台 1 7 を、予めパッケージ 1 の底板上に固定された冷却装置 2 0 上に半田付けして固定する。

【 0 0 7 1 】

その後、半導体レーザ素子 2 およびモニタ用のフォトダイオード 3 は、金ワイヤ（図示せず）を介してパッケージ 1 のリード（図示せず）と電氣的に接続される。

【 0 0 7 2 】

その後、不活性ガス（例えば N_2 , Xe ）雰囲気においてパッケージ 1 上部に蓋 1 c を被せて、その周縁部を抵抗溶接することにより気密封止する。

【 0 0 7 3 】

その後、パッケージ 1 のフランジ部 1 a に対し、第 2 レンズ 1 6 を XY 面内および Z 軸方向で調芯して固定する。この工程では、第 2 レンズ 1 6 の出射光がパッケージ 1 のフランジ部 1 a の中心軸と平行となる位置で YAG レーザ溶接により固定する。

【 0 0 7 4 】

最後に、光ファイバ 8 を調芯して固定する。この工程では、第 2 のレンズ保持部材 2 1 の端部に金属製のスライドリング 2 2 を固定する。スライドリング 2 2 は、第 2 のレンズ保持部材 2 1 の端面において、光ファイバ 8 の光軸と垂直な面内（XY 平面）で位置調整後、両者の境界部において YAG レーザ溶接して固定される。光ファイバ 8 を保持するフェルール 2 3 は、光ファイバ 8 の出力が最大となる位置で、スライドリング 2 2 の内部に YAG レーザ溶接により固定される。これにより、光ファイバ 8 の光軸方向（Z 軸方向）の位置が固定される。

【 0 0 7 5 】

ここで、この実施の形態 1 の半導体レーザモジュールに使用される半導体レーザ素子 2 について説明する。図 6 は、この発明の実施の形態 1 である半導体レーザモジュールに使用される半導体レーザ素子 2 の構成を説明するための説明図である。なお、図 6（B）は、図 6（A）の a-a 線断面図である。

【 0 0 7 6 】

図 6（A）に示すように、半導体レーザ素子 2 は、例えば有機金属気相成長法

、液相法、分子線エピタキシャル成長法、ガスソース分子線エピタキシャル成長法等の公知のエピタキシャル成長法により、所定の半導体からなる基板 2 4 の上に、所定の半導体のエピタキシャル結晶成長を行って、後述する積層構造 2 5 を形成した後、基板 2 4 の底面に下部電極 2 6、積層構造 2 5 の上面に上部電極 2 7 を形成し、劈開を行って所定の共振器長 L 3 とし、さらに一方の劈開面（前端面 2 a）に低反射膜 2 8 を成膜し、他方の劈開面（後端面 2 b）に高反射膜 2 9 を成膜した構造となっている。

【 0 0 7 7 】

図 6（B）に示すように、基板 2 4 上の積層構造 2 5 は、例えば埋め込み型 B H（Buried Heterostructure）構造になっていて、例えば $n\text{-InP}$ から成る基板 2 4 の上に、例えば $n\text{-InP}$ から成る下部クラッド層 3 1、例えば GaInAsP の多層膜からなる G R I N - S C H - M Q W（Graded Index Separate Confinement Hetero structure Multi Quantum Well）構造を有する活性層 3 2、例えば $p\text{-InP}$ からなる上部クラッド層 3 3 が順次積層されており、さらに、上部クラッド層 3 3 の上に、例えば $p\text{-InP}$ からなる上部埋め込み層 3 4、例えば $p\text{-GaInAsP}$ からなるキャップ層 3 5 が積層されている。そして、このキャップ層 3 5 の上に上部電極 2 7 が形成され、また基板 2 4 の底面には下部電極 2 6 が形成されている。

【 0 0 7 8 】

そして、上記した下部クラッド層 3 1、活性層 3 2、上部クラッド層 3 3 は、 $40\sim 60\mu\text{m}$ の間隔を介して互いに平行に並んだ 2 本のストライプ（第 1 のストライプ 9 および第 2 のストライプ 1 0）状に加工され、その側面に例えば $p\text{-InP}$ 層 3 6 と $n\text{-InP}$ 層 3 7 をこの順序で積層することにより、活性層 3 2 への電流注入用の狭窄部が形成されている。

【 0 0 7 9 】

上記した活性層 3 2 としては、例えば、基板 2 4 に対する格子不整合率が 0.5% 以上 1.5% 以下となるような圧縮歪み量子井戸構造を採用し、かつ井戸数が 5 個程度の多重量子井戸構造を使用するのが、高出力化の観点から有利である。また、歪み量子井戸構造として、その障壁層を井戸層の歪みと反対の引っ張り

歪みを導入してなる歪み補償構造とすれば、等価的に格子整合条件を満たすことができるため、井戸層の格子不整合度に関しては上限を設けることは必要でない。また、上記ストライプ状に形成される活性層 32 の幅は、電気抵抗を下げ、かつ横シングルモードで発振させるという観点から、 $2.5 \sim 3 \mu\text{m}$ 程度とした。また、横高次モードをカットオフし、シングルモードをカットオフする活性層の幅は、導波路の設計によって変化するが、高出力化の観点からは、カットオフ幅に比してやや小さい値のストライプ幅を形成するのが好ましい。

【0080】

次に、上記の構造の半導体レーザ素子 2 の製造方法について説明する。まず、有機金属気相成長法、液相法、分子線エピタキシャル成長法、ガスソース分子線エピタキシャル成長法等の公知のエピタキシャル成長法により、基板 24 上に、下部クラッド層 31、GRIN-SCH-MQW 構造を有する活性層 32、上部クラッド層 33 の順に積層する。

【0081】

その後、 $40 \sim 60 \mu\text{m}$ の間隔を介して互いに平行に並んだ 2 本のマスクを上記上部クラッド層 33 上に形成してから、所定のエッチャントを用いて上部クラッド層 33、活性層 32、及び下部クラッド層 31 の一部を溶解し、上記ストライプ側部にさらに、p-InP 層 36 と n-InP 層 37 をこの順序で積層することによって、活性層 32 への電流注入用の狭窄部を形成する。

【0082】

その後、p-InP から成る上部埋め込み層 34 と p-InGaAsP からなるキャップ層 35 をエピタキシャル成長させて積層する。

【0083】

その後、キャップ層 35 の上面に上部電極 27 を形成し、基板 24 の底面に下部電極 26 を形成する。

【0084】

その後、劈開を行って所定の共振器長 L_3 とし、さらに一方の劈開面（前端面 2a）に低反射膜 28 を成膜し、他方の劈開面（後端面 2b）に高反射膜 29 を成膜する。

【 0 0 8 5 】

このようにして作製された半導体レーザ素子 2 は、上部電極 2 7 側を、図示しないヒートシンクに Au Sn 半田等によって接着される。そして、2 つのストライプは、上部電極 2 7（この実施の形態 1 では、p 側）および下部電極 2 6（この実施の形態 1 では、n 側）を通して外部より、供給される電流により、同時にレーザ発振し、低反射膜 2 8 からの 2 つの出力光が前述した偏波合成部材 7 によって合波されて所望の用途に供される。

【 0 0 8 6 】

ここで、2 つのストライプ 9, 1 0 の特性が全く同じであるとする、この実施の形態 1 にかかる半導体レーザ素子 2 のしきい値電流は、ストライプ 1 本のしきい値電流の 2 倍、全出力は、ストライプ 1 本の光出力の 2 倍となる。すなわち、半導体レーザ素子 2 全体としては、ストライプ 1 本当たりの駆動電流の約 2 倍の駆動電流で、約 2 倍の光出力が得られ、半導体レーザ素子 2 のスロープ効率は 1 本のストライプを有する半導体レーザ素子 2 と変わらない。しかも、各ストライプ 9, 1 0 のレーザ光は、横シングルモードで発振しているため、後述の光学系を用いてシングルモードファイバへの高い結合効率を得ることができる。

【 0 0 8 7 】

たとえば、図 7 は、2 つのストライプ 9, 1 0 を用いた W ストライプ構造の半導体レーザ素子 2 と、ストライプ 9, 1 0 と同じ 1 つのストライプを用いた半導体レーザ素子に対する駆動電流に対する光出力と駆動電圧との関係を示した図である。図 7 において、1 つのストライプを用いた半導体レーザ素子による駆動電流に対する光出力特性 L_s は、駆動電流が 1 0 0 0 m A 近傍で飽和しているが、W ストライプ構造の半導体レーザ素子 2 による駆動電流に対する光出力特性 L_w は、駆動電流が 2 0 0 0 m A 近傍で飽和し、1 つのストライプを用いた駆動電流に対する光出力特性 L_s のスロープとほぼ同じスロープを有する。この結果、W ストライプ構造の半導体レーザ素子 2 は、1 つのストライプを用いた半導体レーザ素子に比して 2 倍の光出力を得ることができる。W ストライプの半導体レーザ素子を用いた半導体レーザモジュールにおいては、駆動電流 2 4 0 0 m A において約 5 7 0 m W のファイバ端光出力を、ラマン増幅器で用いられる波長 1 4 3 0

n m帯において、得ることができた。なお、波長約1200nm～約1600nm帯において、約500mW程度のファイバ端光出力を得ることが可能である。

【0088】

ここで、Wストライプの半導体レーザ素子2の駆動電流に対する駆動電圧の変化 V_w と、1つのストライプを用いた半導体レーザ素子の駆動電流に対する駆動電圧の変化 V_s とを比較すると、Wストライプの駆動電圧の変化 V_w は、1つのストライプの駆動電圧の変化 V_s のほぼ半分になっている。これは、Wストライプの場合、駆動電流が注入される領域が2倍になるからである。この結果、半導体レーザ素子の駆動電力すなわち駆動電流×駆動電圧に対する光出力の変換効率、Wストライプの場合、シングルストライプに比して向上する。

【0089】

また、Wストライプの場合、ストライプ1本当たりの駆動電流は、全電流の1/2である。40～60 μ mというストライプ間隔を選ぶことによって、両ストライプ間の熱の影響は十分小さく抑えられ、シングルストライプの場合に近い活性層温度が得られる。

【0090】

レーザ光の発振波長の電流依存性は、主に無効電力による活性層の発熱とこれに伴う屈折率の変化で決まっており、上述したことから、例えば、Wストライプの半導体レーザ素子の駆動電流を100mAから1000mAまで上昇させた時の波長変化 $L_{\lambda w}$ の値は、シングルストライプの半導体レーザ素子の駆動電流を50mAから500mAまで上昇させた時の波長変化 $L_{\lambda s}$ の値とほぼ同じになり、図8に示すように波長安定性が約2倍向上することになる。

【0091】

なお、上記した例では、2つのストライプが同時に駆動される構造を示したが、例えば図9に示すように、2つのストライプの間に上部電極27から活性層32下部の深さにまで及ぶ分離溝38を形成し、その分離溝38表面を絶縁膜39で被覆することにより、2つのストライプを電氣的に分離することができる。このような半導体レーザ素子2の下部電極26側を、図示しないヒートシンクにAuSn半田等により接着すれば、2つのストライプに供給する駆動電流を独立に

制御することも可能となり、光ファイバ 8 から出力されるレーザ光の偏波面をランダム化することが容易となる。

【 0 0 9 2 】

また、上部電極 2 7 側を、図示しないヒートシンクに接着して使用する場合には、ヒートシンク側に、上部電極 2 7 に対応した電極パターンを形成しておくことにより、これら 2 つのストライプを独立に駆動することができる。

【 0 0 9 3 】

また、上記した例では、半導体レーザ素子 2 は、I n P 系の埋め込み型 B H 構造のものを説明したが、例えば図 7 に示すような G a A s 系のリッジ導波路型の半導体レーザ素子 2 であってもよい。図 1 0 に示すように、この半導体レーザ素子 2 は、n - G a A s からなる基板 4 0 上に、n 型下部クラッド層 4 1、活性層 4 2、p 型上部クラッド層 4 3、絶縁層 4 4、p - G a A s 層 4 5 を積層し、2 つのリッジ部が形成されている。絶縁層 4 4 及び p - G a A s 層 4 5 上には上部電極（p 電極）4 6 が形成され、基板 4 0 の底面には下部電極（n 電極）4 7 が形成されている。

【 0 0 9 4 】

ここで、ヒートシンクとして C V D ダイアモンドを用いた構成について説明する。図 1 1 は、半導体レーザ素子 2 の近傍を示す斜視図である。図 1 1 において、半導体レーザ素子 2 およびサーミスタ 2 0 a は、C V D ダイアモンド 1 1 a 上に接着される。さらに、この C V D ダイアモンド 1 1 a の下部は、A l N によって形成されたヒートシンク 1 1 b に結合される。さらに、ヒートシンク 1 1 b の下部には、第 1 の基台 1 7 に対応し、C u W によって形成されたマウント 1 7 a が接着される。C V D ダイアモンド 1 1 a およびヒートシンク 1 1 b は、チップキャリア 1 1 に相当し、2 段のヒートシンクを形成する。C V D ダイアモンド 1 1 a は、高い熱伝導性と絶縁性とを有するため、半導体レーザ素子 2 に発生した熱を効率よく逃がすことができる。

【 0 0 9 5 】

図 1 2 は、2 段のヒートシンクのうち、上部ヒートシンクを C V D ダイアモンド 1 1 a および A l N とした各場合についてサーミスタ 2 1 a の温度を 2 5 ℃と

した場合の活性層32およびマウント17a上部の温度を比較した図である。図12において、上部ヒートシンクをCVDダイヤモンドとした場合の半導体レーザ素子「A」の方が、上部ヒートシンクをAlNとした場合の半導体レーザ素子「B」に比して、活性層の温度が約十数度低くなっている。この場合、上述したように、活性層の温度変化小さい場合、これに伴う屈折率変化が小さくなるため、CVDダイヤモンド11aを用いた半導体レーザ素子「A」は、高い波長安定性を呈することになる。

【0096】

ここで、第1のストライプ9と第2のストライプ10との間隔について検討する。図13は、図6(B)と同様に、図6(A)に示した半導体レーザ素子2のa-a線断面図である。図13において、活性層32の中心線間の距離を「Wc」とし、活性層32の横方向の線幅を「Wa」とし、活性層32の内側側面間の距離を「Ws」とする。ここで、線幅Waは、 $2.5 \sim 3 \mu\text{m}$ であり、距離Wcは、 $10 \sim 100 \mu\text{m}$ としている。したがって、距離Wcが $10 \mu\text{m}$ の場合、距離Wsは $7 \sim 7.5 \mu\text{m}$ となる。また、この関係は、線幅Waとの関連において、距離Wcに対する距離Wsの比が $0.7 \sim 0.97$ であることを示し、線幅Waに対する距離Wcの比が、 $2 \sim 40$ の範囲であることを示している。

【0097】

距離Wcを $10 \sim 100 \mu\text{m}$ としたのは、距離Wcを大きくし過ぎると、半導体レーザ素子4の各ストライプ9、10の中心軸と第1レンズ4と間の距離が大きくなり、第1レンズ4の周縁においてレーザ光がけられることにより、第1レンズ4との結合効率が低下するからである。また、第1レンズ4の周縁部にレーザ光が入射すると、レンズの収差の影響が大きくなり、これによっても結合効率が低下するからである。

【0098】

一方、距離Wcを小さくし過ぎると、活性層32を含む各ストライプ9、10の形成が現段階の微細加工技術では困難であり、各ストライプ9、10の所望のリッジ化や埋め込み成長化が困難になるからである。また、各ストライプ9、10から出力されたレーザ光が互いに干渉してしまうことになるからである。さら

に、各ストライプ9, 10の近接によって、活性層32の発熱が大きくなるからである。

【0099】

たとえば、図14は、CVDダイヤモンド11aを用いた半導体レーザ素子2の間隔 W_c の変化に伴う活性層32の温度変化を示す図である。図14に示すように、間隔 W_c が小さい程、活性層32の温度上昇が大きく、間隔 W_c が40～60 μm 近傍からほぼ一定した温度、すなわち38℃近傍に収束している。なお、図14に示した結果は、周囲温度25℃、マウント17aの底面部温度を25℃に制御している場合である。

【0100】

さらに、距離 W_c を小さくし過ぎると、半導体レーザモジュールM1のモジュールの長さが大きくなる。これは、第1レンズ4によって各ストライプ9, 10からのレーザ光を分離するための光路長が長くなってしまうからである。図15は、半導体レーザモジュールM1の外観図を示している。図15に示す形状をもった半導体レーザモジュールのモジュールサイズを図15に示すように蓋の長手方向の長さ「 L_m 」として定義すると、距離 W_c の変化によって、モジュールサイズ L_m は、図16に示すように変化する。図16において、距離 W_c が5 μm , 10 μm , 40 μm , 60 μm と大きくなる従って、モジュールサイズ L_m は、80mm, 40mm, 25mm, 20mmとなり、距離 W_c が20 μm になると、急激にモジュールサイズ L_m が小さくなり、距離 W_c が40 μm ～60 μm 近傍でモジュールサイズ L_m が20 μm 近傍に収束する。

【0101】

したがって、図14に示した活性層温度の距離 W_c 依存性および図16に示したモジュールサイズの距離 W_c 依存性から、距離 W_c は、40 μm ～60 μm が好ましい。

【0102】

また、活性層32の内側側面間の距離 W_s は、5 μm 以上とすることが好ましい。2つのストライプ間の距離 W_s が小さすぎると、活性層32からの分布漏れした横モード発振のレーザ光が互いに干渉してしまうからである。

【0103】

なお、この実施の形態1では、ファブリ・ペロー型の半導体レーザ素子2を説明したが、活性層32に沿ってまたは活性層32の近傍に形成された部分的回折格子を含む回折格子等の波長選択手段を備えた半導体レーザ素子2を用いてもよい。このような半導体レーザ素子2を使用すれば、ファイバグレーティング付きの光ファイバ8を使用しなくても、発振波長の安定化された光出力を得ることが可能となる。

【0104】

(実施の形態2)

つぎに、この発明の実施の形態2について説明する。図17は、この発明の実施の形態2にかかる半導体レーザモジュールM2の構成を模式化して示す説明図である。図17に示すように、この実施の形態2では、常光線である第1のレーザ光K1が光ファイバ8の軸線方向に伝搬するように、偏波合成部材7の第1のレーザ光K1及び第2のレーザ光K2の入射面が楔形に傾斜して形成されている。この実施の形態2によれば、常光線である第1のレーザ光K1が光ファイバ8の軸線方向に伝搬するので、半波長板6と第1レンズ4との間にプリズム5を配設する必要がなくなり、構成を簡単にすることができる。

【0105】

また、半導体レーザモジュールM2の光軸方向の長さを短くできるので、高温状態における光出力特性に対するパッケージの反りの影響を低減できる。

【0106】

なお、この実施の形態2においても、中心軸周りの角度調整を容易にするため、半波長板6と偏波合成部材7とが同一のホルダ部材14に固定されているのが好ましい。

【0107】

(実施の形態3)

つぎに、この発明の実施の形態3について説明する。図18は、この発明の実施の形態3にかかる半導体レーザモジュールM3の構成を模式化して示す説明図である。この実施の形態3では、常光線である第1のレーザ光K1が光ファイバ

8の軸線方向に伝搬するように、半導体レーザ素子2および第1レンズ4は、軸線方向に対して所定角度傾斜して配置されている。この実施の形態3によれば、常光線である第1のレーザ光K1が光ファイバ8の軸線方向に伝搬するので、半波長板6と第1レンズ4との間にプリズム5を配設する必要がなくなり、構成を簡単にすることができる。また、偏波合成部材7の研磨を片方だけ行えばよいので、実施の形態2に比べ、研磨の簡略化が可能となる。

【0108】

また、半導体レーザモジュールM3の光軸方向の長さを短くできるので、高温状態における光出力特性に対するパッケージの反りの影響を低減できる。

【0109】

なお、この実施の形態3においても、中心軸周りの角度調整を容易にするため、半波長板6と偏波合成部材7とが同一のホルダ部材14に固定されているのが好ましい。

【0110】

上述した実施の形態1～3に示した半導体レーザモジュールM1～M3は、高出力で偏光度が小さく、波長が安定したレーザ光を出力することができるので、エルビウムドープ光ファイバ増幅器やラマン増幅器の励起光源として用いることが可能である。

【0111】

(実施の形態4)

つぎに、この発明の実施の形態4について説明する。図19は、この発明の実施の形態4にかかる光ファイバ増幅器の構成を示すブロック図である。図19に示すように、この発明の実施の形態4にかかる光ファイバ増幅器48は、信号光が入力される入力部49と、信号光が出力される出力部50と、入力部49と出力部50の間で信号光を伝送する光ファイバ（増幅用ファイバ）51と、励起光を発生させる励起光発生部52と、励起光発生部52によって発生された励起光と光ファイバ（増幅用ファイバ）51に伝送される信号光とを合波するWDMカップラ53とを有する。入力部49とWDMカップラ53との間及び出力部50とWDMカップラ53との間には、入力部49から出力部50への方向の信号光だけを

透過させる光アイソレータ 5 4 がそれぞれ設けられている。

【 0 1 1 2 】

励起光発生部 5 2 は、互いに波長帯の異なるレーザ光を出射するこの発明の実施の形態 1 ～ 3 にかかる複数の半導体レーザモジュール M と、半導体レーザモジュール M から出射されたレーザ光を合成する WDM カプラ 5 5 とを有する。

【 0 1 1 3 】

半導体レーザモジュール M から出射された励起光は、WDM カプラ 5 5 によって合成され、励起光発生部 5 2 の出力光となる。

【 0 1 1 4 】

励起光発生部 5 2 で発生した励起光は、WDM カプラ 5 3 により、光ファイバ 5 1 に結合され、一方、入力部 4 9 から入力された信号光は、光ファイバ 5 1 で励起光と合波されて増幅され、WDM カプラ 5 3 を通過し、出力部 5 0 から出力される。

【 0 1 1 5 】

この発明は、上述した実施の形態 1 ～ 4 に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された技術的事項の範囲内において、種々の変更が可能である。例えば、上述した半導体レーザ素子 2 の第 1 のストライプ 9 と第 2 のストライプ 1 0 は、互いに長手方向に平行して延びて形成されているが、これに限らず、例えば図 2 0 に示すように傾斜して形成されていてもよい。この場合、2 本のストライプ 9, 1 0 から出射される 2 本のレーザ光は、半導体レーザ素子 2 から短距離で交差するので、第 1 のレーザ光 K 1 及び第 2 のレーザ光 K 2 が第 1 レンズ 4 を通過後、第 1 のレーザ光 K 1 の光路上にのみ、半波長板 6 を挿入できる程度に十分分離する（図 2 において D' が十分大きくなることをいう）ために必要な伝搬距離（図 2 における L）が短くなるため、半導体レーザモジュール M の光軸方向の長さを短くすることができる。この場合、各ストライプ 9, 1 0 間の距離 W c は、最大値と最小値とを有するが、いずれの値も 1 0 ～ 1 0 0 μ m 程度とすることが好ましい。

【 0 1 1 6 】

また、上述した実施の形態 1 ～ 4 にかかる半導体レーザモジュール M では、半

導体レーザ素子 2 とホルダ部材 1 4 とは同一の冷却装置 2 0 によって冷却されているが、別個の冷却装置を用いて、半導体レーザ素子 2 とホルダ部材 1 4 とを独立に温度制御してもよい。

【 0 1 1 7 】

また、偏光回転手段としては、半波長板 6 を用いることを示したが、例えばファラデー素子を用いて偏光面を回転させてもよい。この場合、ファラデー素子をコイルの内部に配置し、ファラデー素子に印加する磁界強度をコイルに流す電流の大きさによって可変にすれば、レーザの波長のばらつきや、温度のばらつきによる偏光面の回転角のばらつきを、コイルに流す電流の大きさを調整することによって個々に補償することが可能となる。

【 0 1 1 8 】

【発明の効果】

以上説明したように、この発明によれば、半導体基板の一部領域上に積層された第 1 の活性層を有し、第 1 のレーザ光を出射する第 1 のストライプと、前記半導体基板の他の領域上に積層された第 2 の活性層を有し、第 2 のレーザ光を出射する第 2 のストライプとを備えているので、1 つのストライプを有する半導体レーザ素子に比して、略 2 倍の光出力が得られる光出力特性が得られ、直列抵抗が略 $1/2$ になることから、熱発生が抑えられ、活性層の屈折率変化が抑えられ、略 2 倍の波長安定性を得ることができる。また、駆動電圧を低減できるため、1 つのストライプすなわちシングルストライプ型に比して、光出力当たりの消費電力を低減できるとともに、最大光出力を約 2 倍に向上できる。この際、第 1 のストライプと第 2 のストライプとの中心線間距離を $100\ \mu\text{m}$ 以下とすることによって、第 1 レンズの周縁におけるレーザ光のけられによる結合効率の低下や、レンズの収差の影響による結合効率の低下を抑えることができる。さらに、この中心間距離を $10\ \mu\text{m}$ 以上とすることによって、活性層の温度上昇が抑えられるので、波長安定性の低下が抑えられ、また、半導体レーザモジュールのサイズの大小型化を抑えることができる。また、各ストライプの内側側面間距離を $5\ \mu\text{m}$ 以上とすることによって、各ストライプ間から分布漏れしたレーザ光の干渉を防ぐことができる。

【0119】

また、少なくとも一部がダイヤモンドによって形成されたヒートシンク上に半導体レーザ素子を固定することによって、半導体レーザ素子が発生する熱を効率よく逃がすことができ、熱発生による波長安定性の低下を抑えることができる。

【0120】

さらに、この発明によれば、半導体レーザ素子から第1のレーザ光及び第2のレーザ光が出射され、偏光回転手段によって一方のレーザ光の偏光面が所定角度回転され、偏波合成手段によって第1のレーザ光と第2のレーザ光が偏波合成されるので、光ファイバからは偏光度の小さい高強度のレーザ光を出力することができる。また、光ファイバにファイバグレーティングなどの光反射部が形成されていれば、光ファイバから波長が固定されたレーザ光を出力することができる。従って、上記の半導体レーザモジュールを、高出力特性、低偏波依存性および波長安定性が要求されるエルビウムドープ光ファイバ増幅器やラマン増幅器の励起光源として適用することができる。

【0121】

また、2つのレーザ光を出射させる2つのストライプを備えた1個の半導体レーザ素子および1個の第1レンズだけを用いているので、半導体レーザ素子および第1レンズの位置決め時間が短くなる。その結果、半導体レーザモジュールの製造時間を短縮化できる。

【0122】

また、従来は2つの半導体レーザ素子からそれぞれ全く異なる軸方向に光が出射されるため、そのそれぞれの軸方向でのパッケージの反り等を考慮して半導体レーザモジュールを設計しなければ、環境温度の変化等によって生じたパッケージの反りによる光出力変動を抑制できなかったが、この発明によれば、1個の半導体レーザ素子から出力される2つの光は略同じ方向に伝搬されるため、パッケージの反りの影響を1方向においてのみ抑制することにより、光ファイバから出力される光の強度の安定化を図ることができる。

【0123】

また、1個の半導体レーザ素子から2つの光を出力することにより、これら2

つの光はパッケージの反りに対して、光ファイバとの結合効率が同じ傾向で変動する。従って、温度変動等があった場合でも光ファイバから出力される光の偏光度が安定化する。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

この発明の実施の形態 1 にかかる半導体レーザモジュールの構成を示す側面断面図である。

【図 2】

この発明の実施の形態 1 にかかる半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【図 3】

(A) は、プリズムの構成を示す側面図であり、(B) は、その平面図である。

【図 4】

(A) は、プリズム、半波長板および偏波合成部材を固定するホルダを示す平面図であり、(B) は、その側面断面図であり、(C) は、その正面図である。

【図 5】

(A) および (B) は、第 1 レンズの調芯工程を説明するための説明図である。

【図 6】

(A) および (B) は、半導体レーザ素子の構成を説明するための説明図である。

【図 7】

図 6 に示した W ストライプ構造の半導体レーザ素子と 1 つのストライプ構造の半導体レーザ素子との駆動電流に対する光出力特性および駆動電圧特性とを示す図である。

【図 8】

図 6 に示した W ストライプ構造の半導体レーザ素子と 1 つのストライプ構造の半導体レーザ素子との駆動電流に対する波長変化特性を示す図である。

【図 9】

半導体レーザ素子の他の構成を示す断面図である。

【図 1 0】

半導体レーザ素子の他の構成を示す断面図である。

【図 1 1】

CVDダイヤモンドをヒートシンクとして用いた場合における半導体レーザ素子近傍の構成を示す斜視図である。

【図 1 2】

CVDダイヤモンドを用いた場合と用いない場合とにおける活性層温度の違いを示す図である。

【図 1 3】

第 1 のストライプと第 2 のストライプとの距離関係を示す説明図である。

【図 1 4】

活性層間の距離に対する活性層の温度変化を示す図である。

【図 1 5】

半導体レーザモジュールの外観とモジュールサイズを説明する図である。

【図 1 6】

活性層間の距離に対するモジュールサイズの変化を示す図である。

【図 1 7】

この発明の実施の形態 2 にかかる半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【図 1 8】

この発明の実施の形態 3 にかかる半導体レーザモジュールの構成を模式化して示す説明図である。

【図 1 9】

この発明の実施の形態 4 にかかる光ファイバ増幅器の構成を示すブロック図である。

【図 2 0】

半導体レーザ素子の 2 本のストライプが互いに傾斜して形成された場合を示す

図である。

【図 2 1】

米国特許第 5 5 8 9 6 8 4 号公報に開示された半導体レーザ装置を説明するための説明図である。

【符号の説明】

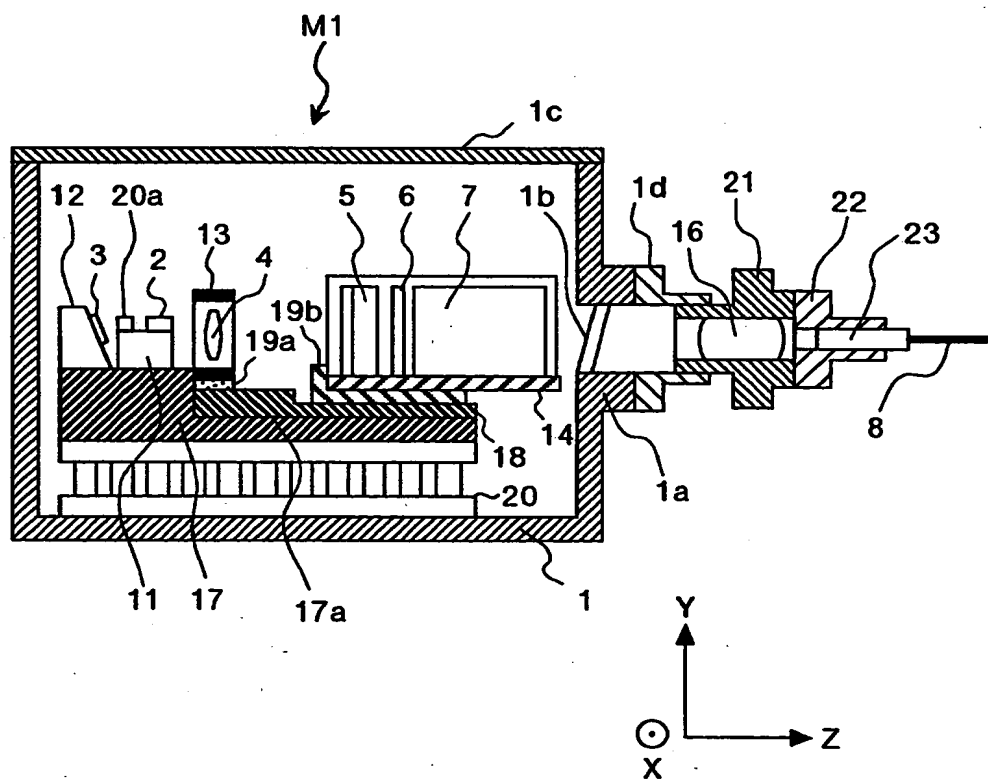
- K 1 第 1 のレーザ光
- K 2 第 2 のレーザ光
- M, M 1, M 2, M 3 半導体レーザモジュール
 - 1 パッケージ
 - 1 a フランジ部
 - 1 b 窓部
 - 1 c 蓋
 - 1 d 中間部材
 - 2 半導体レーザ素子
 - 3 フォトダイオード
 - 4 第 1 レンズ
 - 5 プリズム
 - 6 半波長板（偏光回転手段）
 - 7 偏波合成部材
 - 7 a 第 1 のポート
 - 7 b 第 2 のポート
 - 7 c 第 3 のポート
 - 8 光ファイバ
 - 9 第 1 のストライプ
 - 1 0 第 2 のストライプ
 - 1 1 チップキャリア
 - 1 2 フォトダイオードキャリア
 - 1 3 第 1 のレンズ保持部材
 - 1 4 ホルダ部材

- 15 光反射部
- 16 第2レンズ
- 17 第1の基台
- 18 第2の基台
- 19a 第1の支持部材
- 19b 第2の支持部材
- 20 冷却装置
- 20a サーミスタ
- 21 第2のレンズ保持部材
- 22 スライドリング
- 23 フェルール
- 24 基板
- 25 積層構造
- 26 下部電極
- 27 上部電極
- 28 低反射膜
- 29 高反射膜
- 31 下部クラッド層
- 32 活性層
- 33 上部クラッド層
- 34 上部埋め込み層
- 35 キャップ層
- 36 p-InP層
- 37 n-InP層
- 38 分離溝
- 39 絶縁膜
- 40 基板
- 41 n型下部クラッド層
- 42 活性層

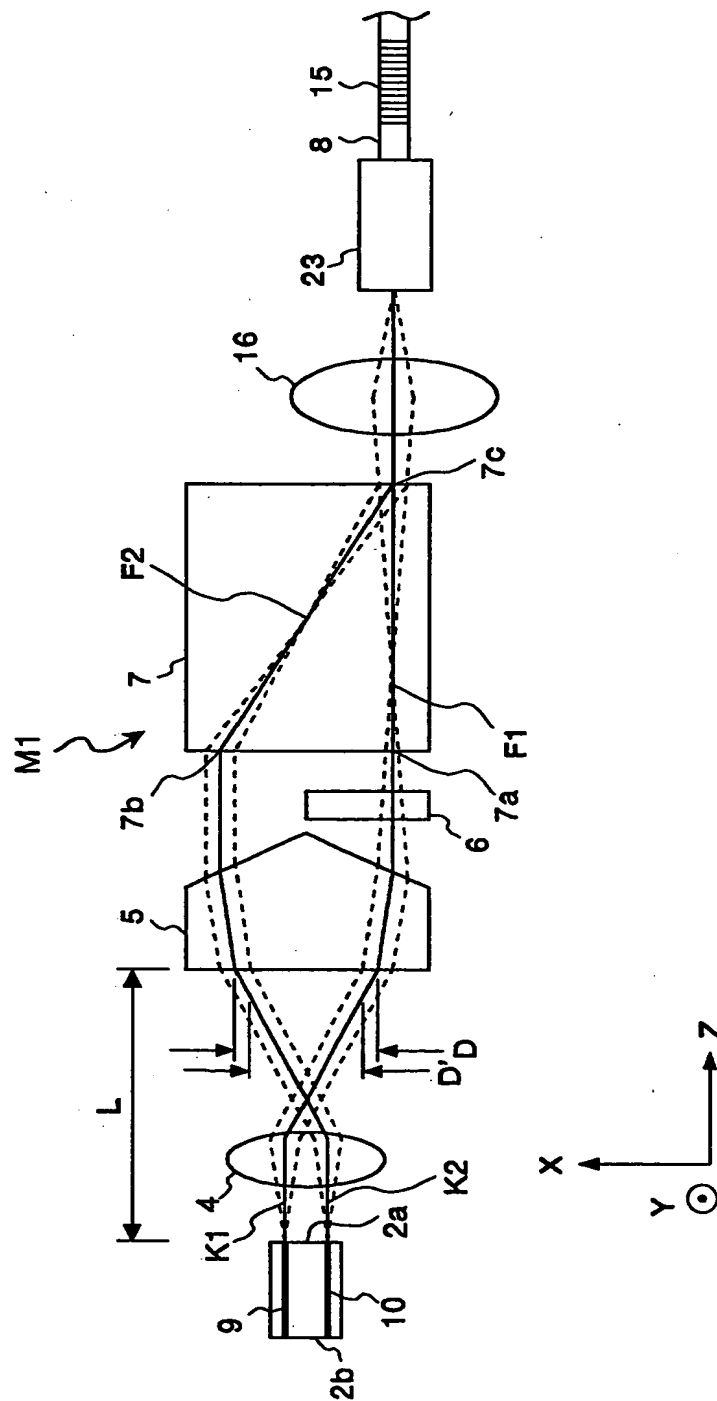
- 4 3 p 型上部クラッド層
- 4 4 絶縁層
- 4 5 p - G a A s 層
- 4 6 上部電極
- 4 7 下部電極
- 4 9 入力部
- 5 0 出力部
- 5 1 光ファイバ
- 5 2 励起光発生部
- 5 3 WDMカプラ
- 5 4 光アイソレータ
- 5 5 WDMカプラ

【書類名】 図面

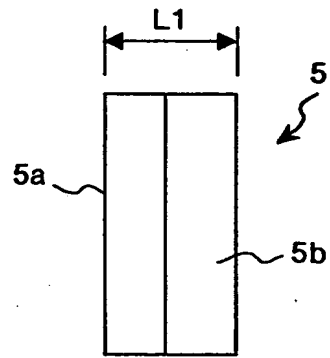
【図 1】



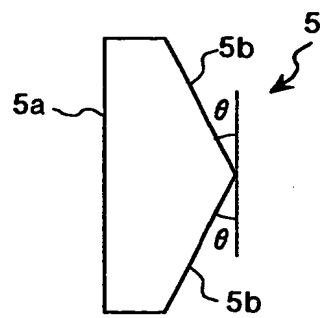
【図 2】



【図 3】

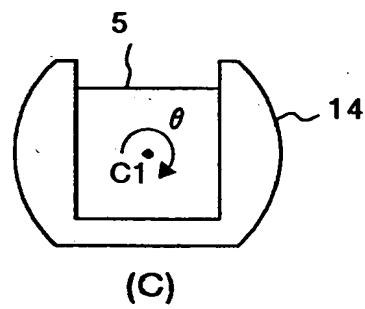
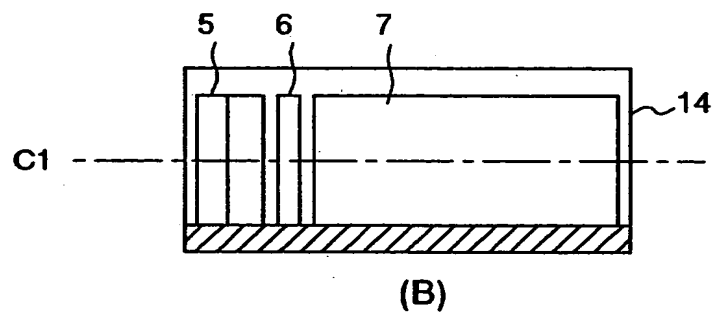
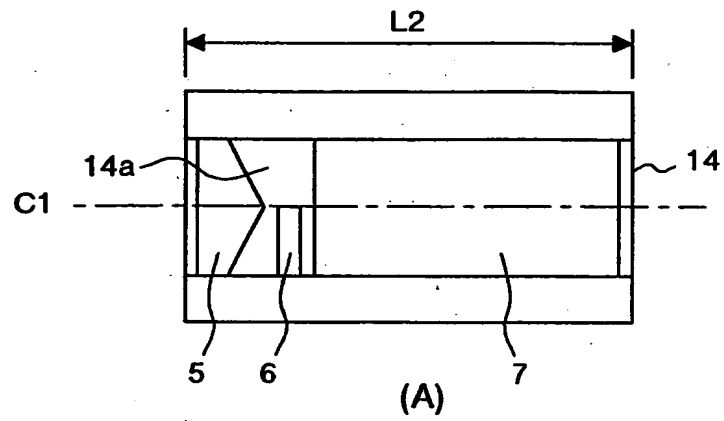


(A)

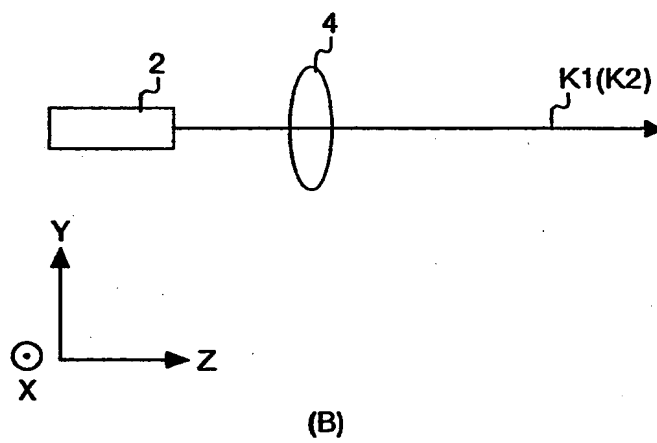
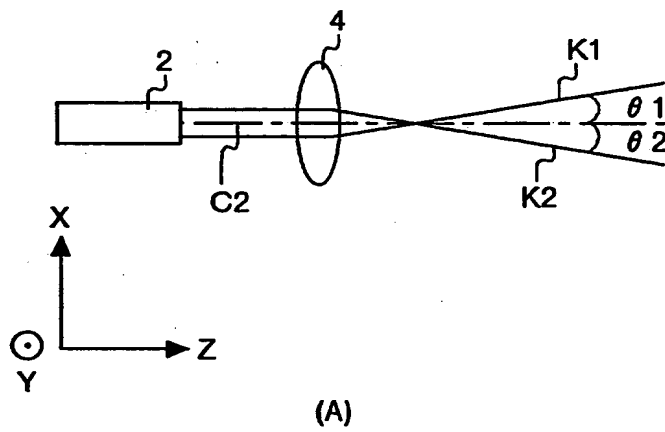


(B)

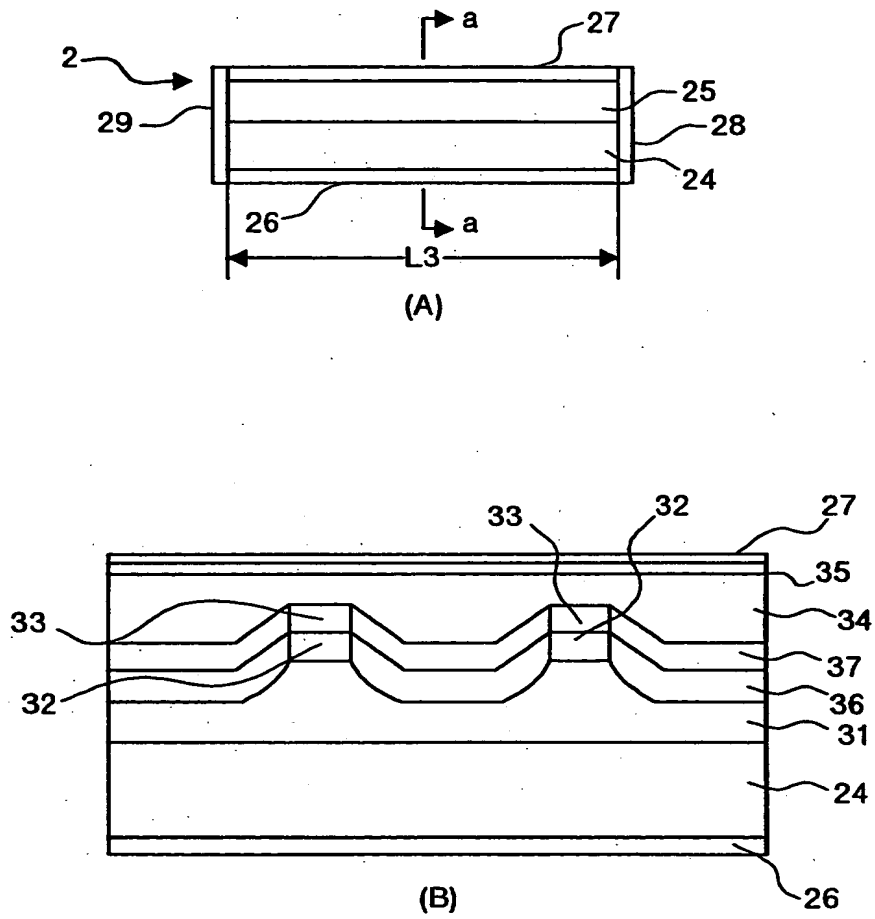
【図 4】



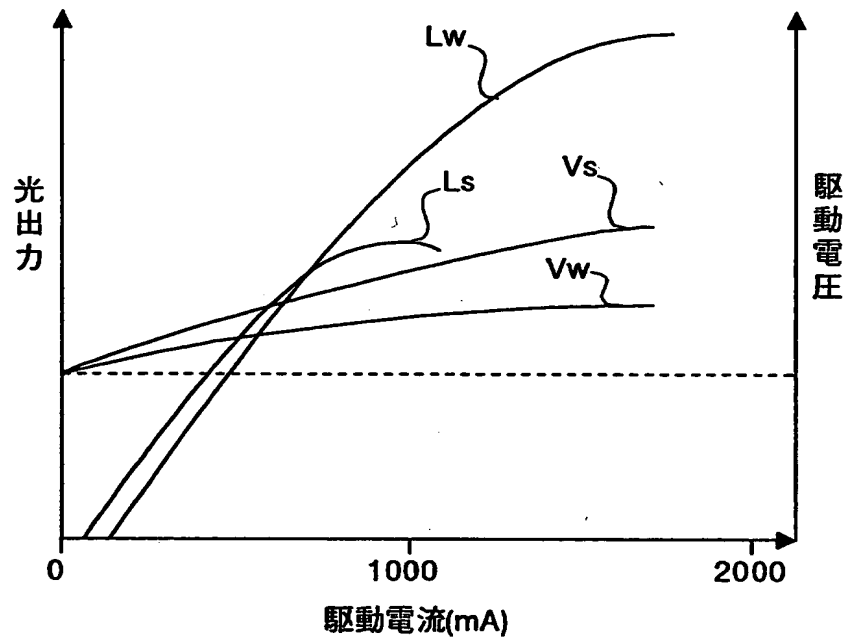
【図 5】



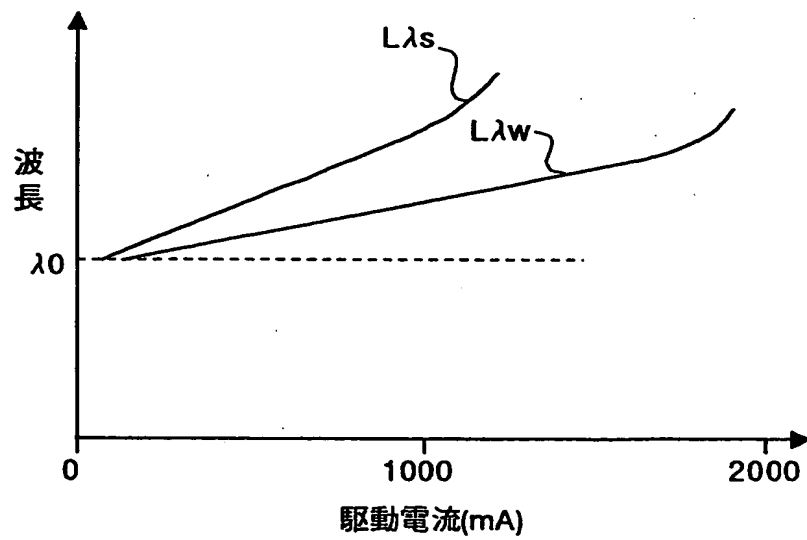
【図 6】



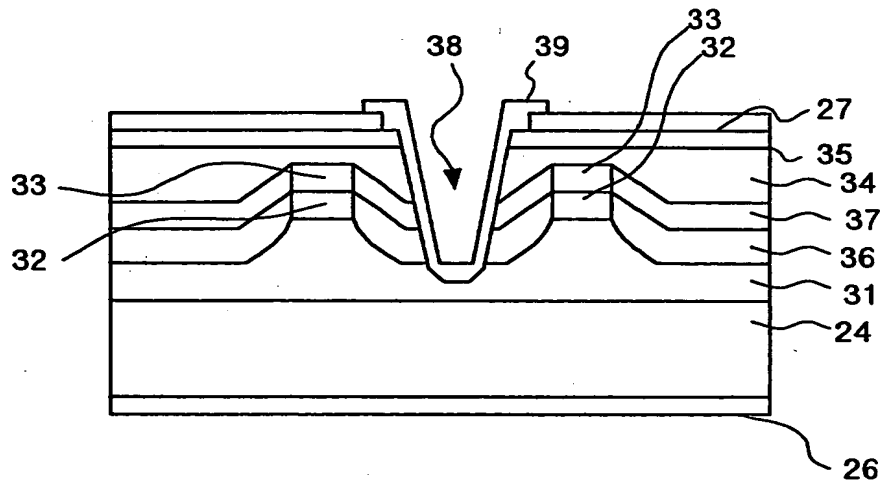
【図 7】



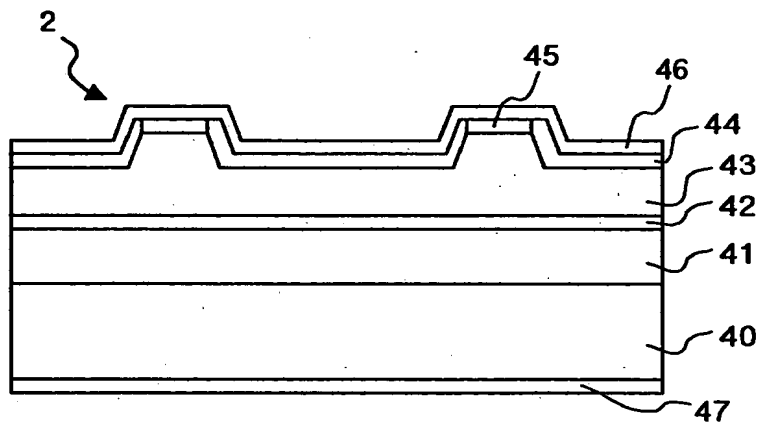
【図 8】



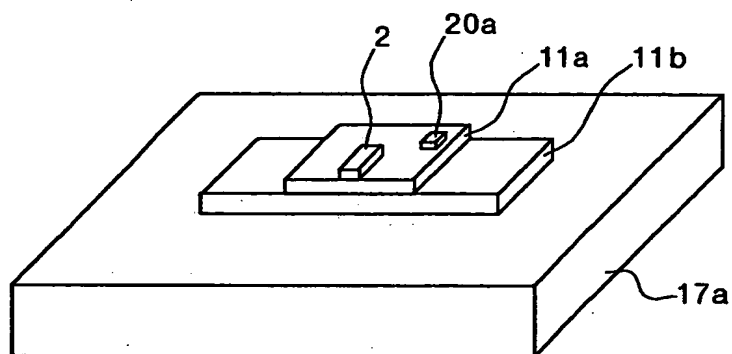
【図9】



【図10】



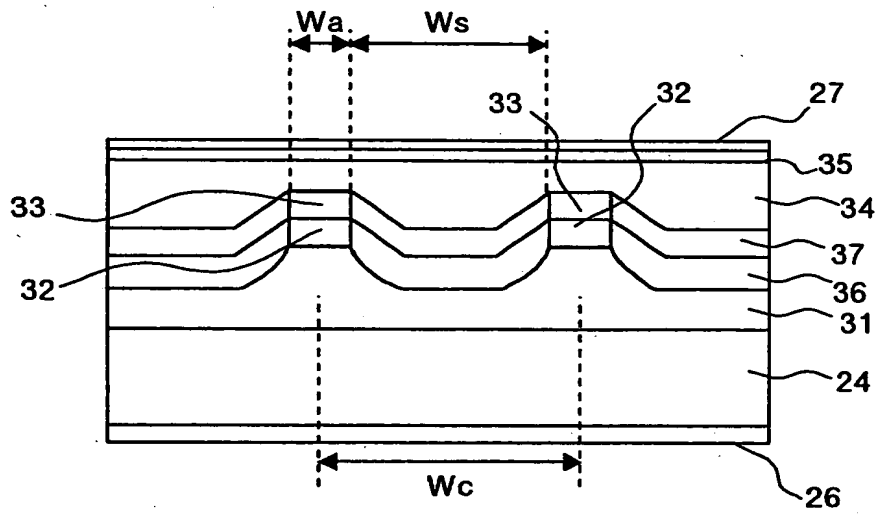
【図 1 1】



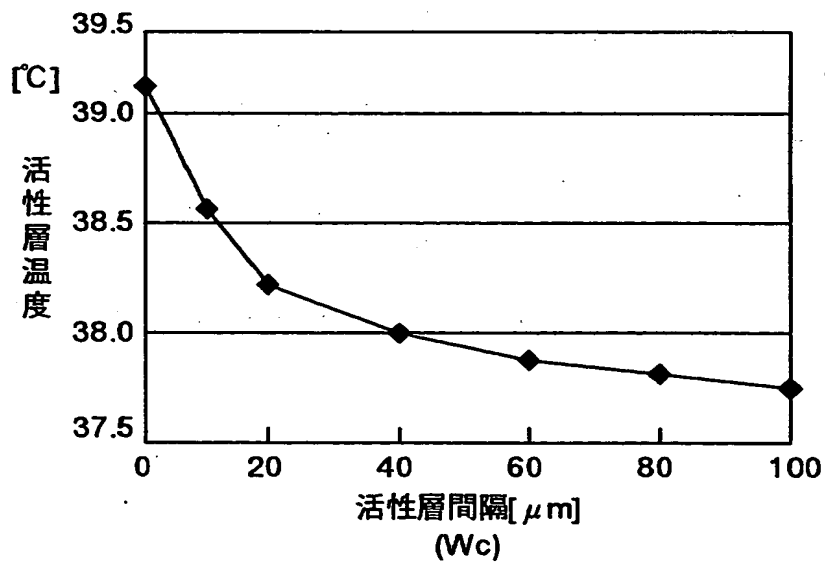
【図 1 2】

		A	B
上部ヒートシンク		CVDダイヤモンド	AlN
下部ヒートシンク		AlN	AlN
発熱量[W]	左活性層	2.5	2.5
	右活性層	2.5	2.5
温度[℃]	左活性層	37.96	49.53
	右活性層	37.96	49.53
	マウント上部	26.76	26.77

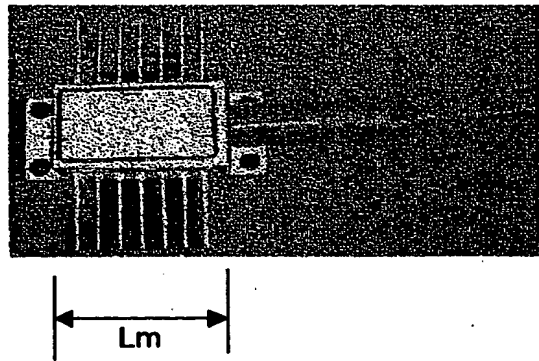
【図 13】



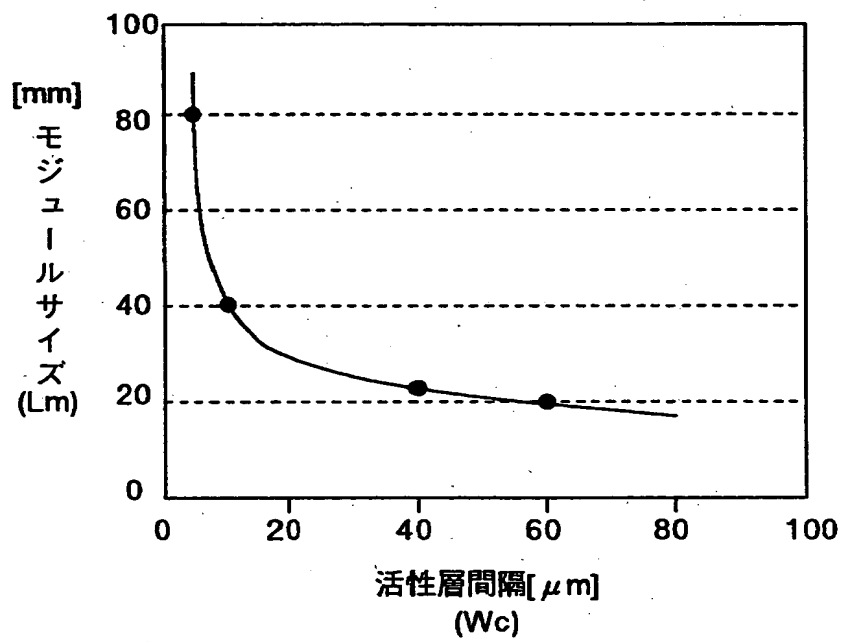
【図 14】



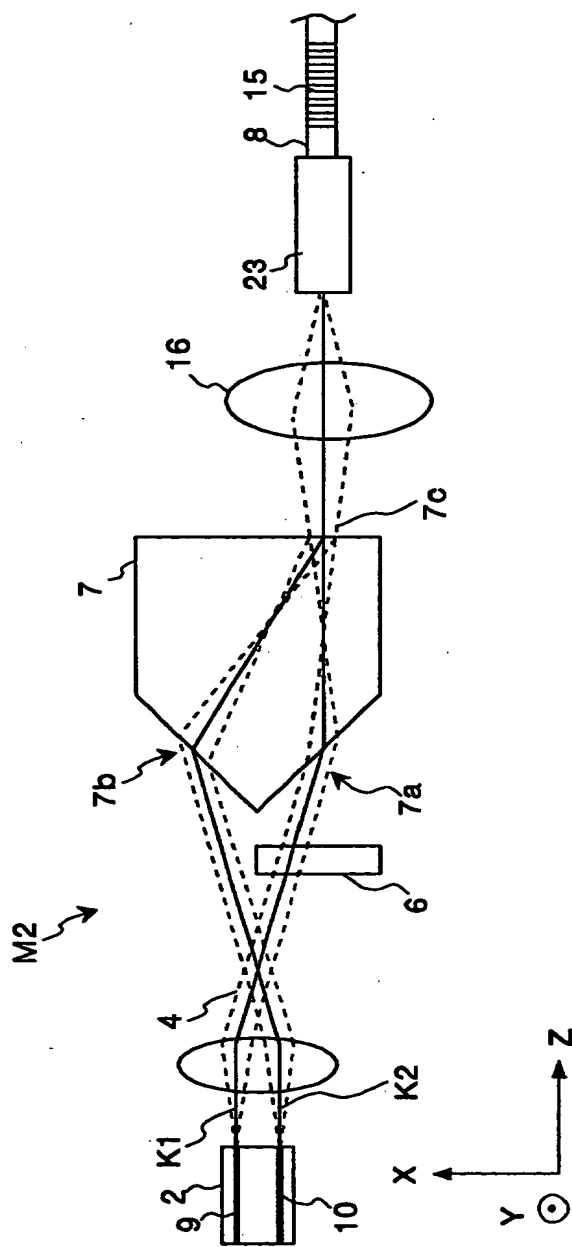
【図15】



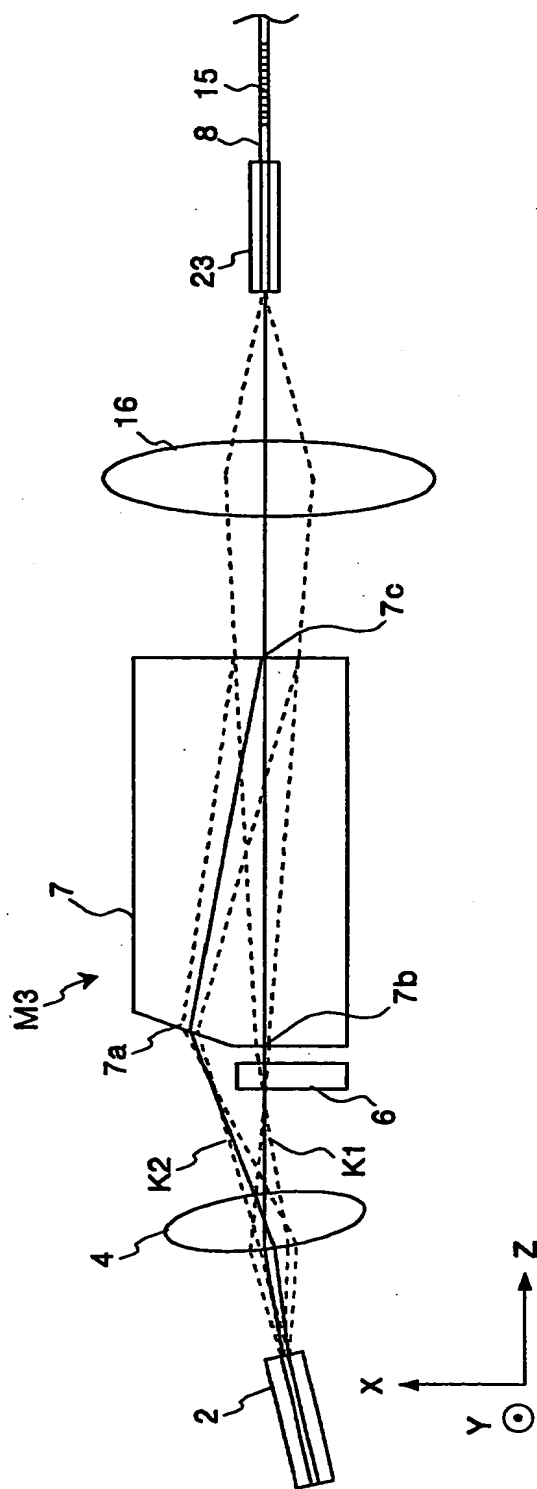
【図16】



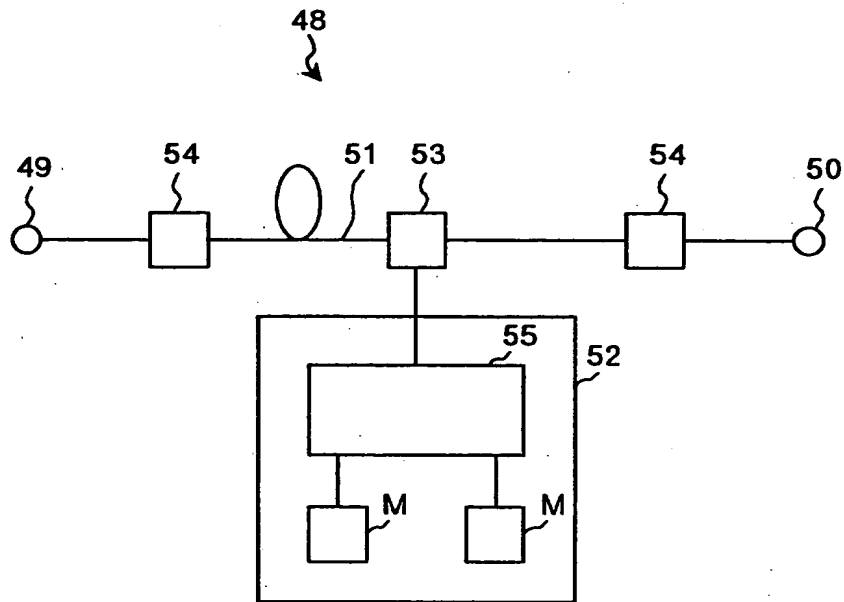
【図 17】



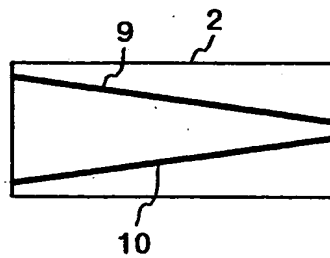
【図18】



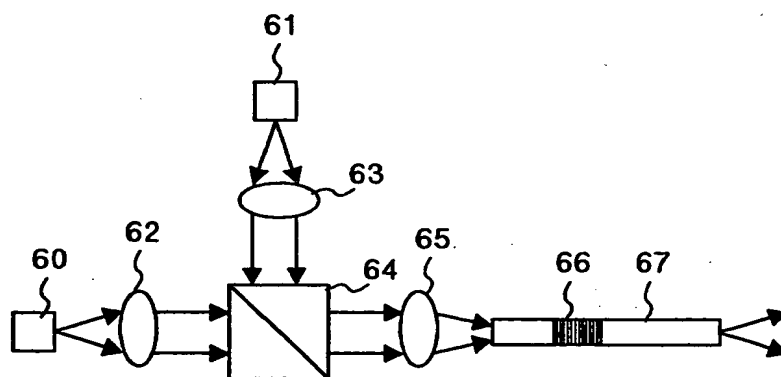
【図 1 9】



【図 2 0】



【図 2 1】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 半導体レーザー素子の位置決め時間及びレンズの調芯時間を短くするとともに、半導体レーザーモジュールから出力されるレーザー光の光強度及び偏光度の安定化を図ること。

【解決手段】 間隔を隔てて形成された第1のストライプ9及び第2のストライプ10を有し、第1のストライプ9及び第2のストライプ10の端面からそれぞれ第1のレーザー光K1及び第2のレーザー光K2を出射する半導体レーザー素子2と、半導体レーザー素子2から出射された第1のレーザー光K1と第2のレーザー光K2との間隔を広げるように分離させる第1レンズ4と、第1のレーザー光K1の偏波面を90度回転させる半波長板6と、入射された第1のレーザー光K1と第2のレーザー光K2とが合波されて出射される偏波合成部材7と、偏波合成部材7から出射されるレーザー光を受光し外部に送出する光ファイバ8とを有する。

【選択図】 図2

特2001-382233

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005290]

1. 変更年月日	1990年 8月29日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都千代田区丸の内2丁目6番1号
氏 名	古河電気工業株式会社